# TPS281C100x 60V、100mΩ、シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ

## 1 特長

- 広い動作電圧範囲:6V ～ 60V
- 低 $R_{ON}$:83mΩ (標準値)、168mΩ (最大値)
- 可変電流制限によるシステム レベルの信頼性の向上
  - 1A～5A (固定 0.5A)
- 高精度電流検出
  - 標準センス モードで 1A 時に ±4%
  - 高精度センス モードで 4mA 時に ±12.5%
- 64V を超える誘導性放電クランプを内蔵
- 1.5mA 未満の低静止電流
- 動作時の接合部温度:–40 ～ 125°C
- 入力制御:1.8V、3.3V、5V ロジック互換
- ADC 保護のためのフォルト検出電圧スケーリングを内蔵
- オフ状態での開路検出
- サーマル シャットダウンおよびスイング検出
- IEC61000-4-4 に準拠した強化電気的高速過渡 (EFT)
  - 22nF の出力容量、DIAG_EN を Low にした ±2kV EFT でデバイスはオフを維持
- 熱特性強化型 14 ピン TSSOP パッケージ
- 熱特性強化型 12 ピン WSON パッケージ

## 2 アプリケーション

- デジタル出力モジュール
- セーフ トルク オフ (STO)
- 保持ブレーキ
- 一般的な抵抗性、誘導性、容量性負荷

## 3 説明

TPS281C100 は、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、シングル チャネル スマート ハイサイド スイッチです。$R_{ON}$ が低いためデバイスの電力散逸が最小になり、広い範囲の出力負荷電流を駆動でき、最大 DC 60V の動作範囲によりシステムの堅牢性が向上します。

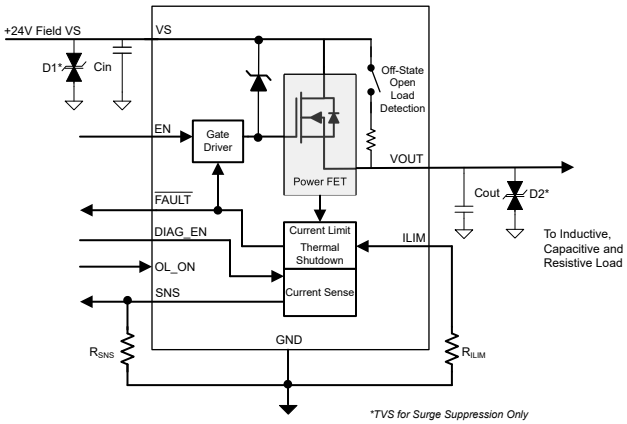
このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。TPS281C100 は、可変電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。ランプや高速充電の容量性負荷など、大きな突入電流の負荷を駆動するために、TPS281C100A では、より高いレベルの許容電流を使用した突入電流期間が設定されています。本デバイスは、過負荷およびオープン負荷の検出などの負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。

TPS281C100 は、小型の 14 ピン、0.65mm ピン ピッチの 4.4mm × 5mm HTSSOP リード付きパッケージ、および 12 ピン、0.5mm ピンピッチの 4mm × 4mm WSON で供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

**パッケージ情報**

| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TPS281C100x | DNT (WSON, 12) | 4mm × 4mm |

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。




**代表的なアプリケーション回路図**

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

# 目次

**1 特長** ... 1
**2 アプリケーション** ... 1
**3 説明** ... 1
**4 デバイスのオプション** ... 3
**5 ピン構成および機能** ... 4
**6 仕様** ... 5
6.1 絶対最大定格 ... 5
6.2 ESD 定格 ... 5
6.3 推奨動作条件 ... 5
6.4 熱に関する情報 ... 6
6.5 電気的特性 ... 6
6.6 SNS タイミング特性 ... 10
6.7 スイッチング特性 ... 11
6.8 代表的特性 ... 12
**7 パラメータ測定情報** ... 14
**8 詳細説明** ... 16
8.1 概要 ... 16
8.2 機能ブロック図 ... 17
8.3 デバイスの機能モード ... 17
8.4 作業モード ... 17
8.5 機能説明 ... 18
**9 アプリケーションと実装** ... 36
9.1 使用上の注意 ... 36
9.2 代表的なアプリケーション ... 36
9.3 電源に関する推奨事項 ... 38
9.4 レイアウト ... 39
**10 デバイスおよびドキュメントのサポート** ... 41
10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法 ... 41
10.2 サポート・リソース ... 41
10.3 商標 ... 41
10.4 静電気放電に関する注意事項 ... 41
10.5 用語集 ... 41
**11 改訂履歴** ... 41
**12 メカニカル、パッケージ、および注文情報** ... 41


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

# 4 デバイスのオプション

| デバイス バージョン | 部品番号 | 電流制限範囲 | 誘導性負荷の内蔵クランプ | 突入電流期間 |
|---|---|---|---|---|
| A | TPS281C100A | 1A ～ 5A (GND への ILIM 短絡で固定 0.5A) | 有 | 有 |
| B | TPS281C100B | 1A ～ 5A (GND への ILIM 短絡で固定 0.5A) | 有 | 無 |

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

# 5 ピン構成および機能

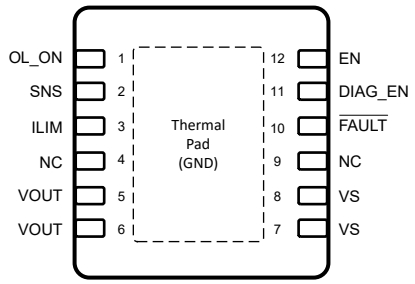



**図 5-1. DNT パッケージ、12 ピン WSON(上面図)**

**表 5-1. ピンの機能**

| ピン | | タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | DNT | | |
| GND | パッド | 電源 | デバイスのグランド。抵抗とダイオードのグランド ネットワークに接続すると、逆極性保護を行うことができます。 |
| EN | 12 | I | チャネルのアクティブ化のための入力制御。内部プルダウン。 |
| DIAG_EN | 11 | I | 診断用イネーブル / ディスエーブル ピンおよび電流検出。内部プルダウン。 |
| $\overline{\text{FAULT}}$ | 10 | O | オープン ドレインの全体的な故障出力。$\overline{\text{FLT}}$ または故障ピンと呼ばれます。アクティブ LOW 信号。 |
| OL_ON | 1 | I | イネーブル / ディスエーブル ピンにより、高分解能の電流センスを実現 ($I_{OUT}$ < $I_{Ksns2_EN}$ の場合のみ使用可能)。内部プルダウン。 |
| SNS | 2 | O | 負荷電流に対応するアナログ電流出力。GND に抵抗を接続して電圧に変換します。 |
| ILIM | 3 | O | 調整可能な電流制限。電流制限を設定するための抵抗を接続します。オプションとして、グランドへ短絡するか、ピンをフローティングのままにして、電流制限をデフォルトの内部電流制限に設定します。詳細については、「電気的特性」を参照してください。 |
| NC | 4、9 | 該当なし | 内部接続なし |
| VOUT | 5、6 | 電源 | ハイサイド スイッチの出力、負荷に接続されます。 |
| VS | 7、8 | 電源 | 電源入力。 |
| パッド | パッド | — | サーマル パッドは内部でグラウンドに短絡します。 |

### 未使用ピンの推奨接続

TPS281C100x は、診断機能および保護機能の拡張セットを提供するよう設計されています。ただし、システム設計で許容される I/O 接続の数が限られている場合、一部のピンはオプションと見なすことができます。

**表 5-2. オプション ピンの接続**

| ピン名 | 未使用時は接続 | 未使用時の影響 |
|---|---|---|
| SNS | 10kΩ 抵抗を介したグランド | アナログ センス機能は利用できません。 |
| ILIM | 浮動 | ILIM ピンがフローティングのままになると、デバイスはデフォルトの内部電流制限スレッショルドに設定されます。 |
| $\overline{\text{FAULT}}$ | 浮動 | $\overline{\text{FAULT}}$ ピンを使用しない場合、システムは出力からフォルトを読み出すことができません。 |
| DIAG_EN | $R_{PROT}$ 抵抗を介したフロートまたはグランド | DIAG_EN を使用しない場合、アナログ センス、開放負荷、電源への短絡の診断機能は使用できません。 |
| OL_ON | $R_{PROT}$ 抵抗を介して接地します | OL_ON を未使用の場合、高精度のセンス モードは使用できません。 |


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

# 6 仕様

## 6.1 絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)

| | | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 連続電源電圧、IC GND を基準とした $V_S$:バージョン A、B | | -0.7 | 64 | V |
| 連続電源電圧、IC GND を基準とした $V_{OUT}$:バージョン A、B | | -60 | 64 | V |
| 電源ピンでの過渡電圧 (100µs 未満)。IC GND を基準とした $V_S$ :バージョン A、B | | -0.7 | 81 | V |
| イネーブル・ピン電圧、$V_{EN}$ | | -1 | 6 | V |
| OL_ON ピン電圧、$V_{OL_ON}$ | | -1 | 6 | V |
| DIAG_EN ピン電圧、$V_{DIAG_EN}$ | | -1 | 6 | V |
| センス・ピン電圧、$V_{SNS}$ | | -1 | 6 | V |
| $\overline{FAULT}$ ピン電圧、$V_{\overline{FAULT}}$ | | -1 | 6 | V |
| 逆グランド電流、$I_{GND}$ | $V_S$ < 0V | | -50 | mA |
| 最大接合部温度、$T_J$ | | | 150 | °C |
| 保管温度、$T_{stg}$ | | -65 | 150 | °C |

(1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、その条件で、または「推奨動作条件」に記載されている条件を超える条件で、デバイスが機能するという意味ではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全には機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。

## 6.2 ESD 定格

| | | | | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_{ESD}$ | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠(1) | VS と VOUT を除くすべてのピン | ±2000 | V |
| | | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠(1) | GND を基準とした VS および VOUT | ±4000 | V |
| | | デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン(2) | すべてのピン | ±750 | V |
| $V_{(ESD4)}$ | 静電放電 | 接触放電、IEC 61000-4-2 に準拠(3) | VS および VOUT | ±8000 | V |
| $V_{(EFT)}$ | 静電放電 | 電気的高速過渡応答、IEC 61000-4-4 準拠(3) | VS および VOUT | ±2000 | V |
| $V_{(surge)}$ | 静電放電 | 42Ω でのサージ保護機能、IEC 61000-4-5 準拠、1.2/50µs (4) | VS および VOUT | ±1000 | V |

(1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
(3) アプリケーション回路および供給電圧 (VS) 24V、ENx ピン High (出力有効) および EN ピン Low (出力無効) でテスト済み。
(4) アプリケーション回路および供給電圧 (VS) 24V、ENx ピン High (出力有効) および EN ピン Low (出力無効) でテスト済み。VS および VOUT に外部 TVS が必要。「IEC 61000-4-5 サージ」セクションを参照してください。

## 6.3 推奨動作条件

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)

| | | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| $V_{S_OP_NOM}$ | 公称電源電圧 | 6.0 | 60 | V |
| $V_{EN}$ | イネーブル電圧 | -1 | 5.5 | V |
| $V_{OL_ON}$ | OL_ON ピン電圧、$V_{OL_ON}$ | -1 | 5.5 | V |
| $V_{DIAG_EN}$ | 診断イネーブル電圧 | -1 | 5.5 | V |
| $V_{FAULT}$ | $\overline{FAULT}$ ピン電圧 | -1 | 5.5 | V |

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 6.3 推奨動作条件 (続き)

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)

| | | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| $V_{SNS}$ | センス電圧 | -1 | 5.5 | V |
| $T_A$ | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | °C |

(1) すべての動作電圧条件は、デバイスの GND を基準として測定されています。

## 6.4 熱に関する情報

| 熱評価基準(1)(2) | | TPS281C100x<br>DNT (WSON)<br>12 ピン | 単位 |
|---|---|---|---|
| $R_{\theta JA}$ | 接合部から周囲への熱抵抗 | 36.9 | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 24.4 | °C/W |
| $R_{\theta JB}$ | 接合部から基板への熱抵抗 | 13.7 | °C/W |
| $\psi_{JT}$ | 接合部から上面への特性パラメータ | 0.4 | °C/W |
| $\psi_{JB}$ | 接合部から基板への特性パラメータ | 13.7 | °C/W |
| $R_{\theta JC(bot)}$ | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 1.1 | °C/W |

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、SPRA953 のアプリケーション レポートを参照してください。
(2) 熱パラメータは、JESD51-5 および JESD51-7 に準拠した 4 層 PCB に基づいています。

## 6.5 電気的特性

$V_S$ = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40°C ～ 125°C (特に記述のない限り)

| パラメータ | | テスト条件 | | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VS 電源電圧および電流** | | | | | | | |
| $I_{L_{NOM}}$ | 連続負荷電流 | $V_{EN}$ = HI | $T_{AMB}$ = 85°C | | 4 | | A |
| $I_{IDLE, VS}$ | 診断がディスエーブルの状態でデバイスの総アイドル状態電流 (MOSFET を含む) | VS ≤ 60V、$V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = LO、$V_{OUT}$ = 0V | $T_J$ = –40°C～85°C | | 1 | 1.3 | mA |
| | | | $T_J$ = 150°C | | | 1.5 | mA |
| $I_{IDLE, VS_DIAG}$ | 診断がイネーブルの状態で $V_S$ スタンバイ アイドル状態電流 | VS ≤ 60V、$V_{EN}$ = LO、$V_{DIAG_EN}$ = HI、$V_{OUT}$ = 0V | | | 1.2 | 1.7 | mA |
| $I_{Q, VS}$ | 診断がディスエーブルの状態で $V_S$ 静止電流 | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 0V | $I_{OUT}$ = 0A | | 0.98 | 1.3 | mA |
| $I_{Q, VS_DIAG}$ | 診断がイネーブルの状態で $V_S$ 静止電流 | $V_{ENx}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 0V | $I_{OUT}$ = 0A | | 1.2 | 1.5 | mA |
| $I_{OUT(OFF,SINK)}$ | 出力シンク電流 | VS ≤ 60V、$V_{EN}$ = 0V、$V_{OUT}$ = 24V、$V_{DIAG}$ = 0V | $T_J$ = –40°C～85°C | | 2.1 | 2.8 | mA |
| | | | $T_J$ = 150°C | | 2.3 | 2.6 | mA |
| $V_{OUT(OFF)}$ | 出力フローティング電圧 | VS ≤ 60V、$V_{EN}$ = 0V、$V_{OUT}$ フローティング、$V_{DIAG}$ = 0V | $T_J$ = –40°C～85°C | | | 0.9 | V |
| | | | $T_J$ = 150°C | | | 0.9 | V |
| **VS 低電圧誤動作防止 (UVLO) 入力** | | | | | | | |
| $V_{S,UVLOR}$ | $V_S$ 低電圧誤動作防止の立ち上がり | デバイスの GND ピンに関して測定 | | 5.0 | 5.4 | 5.75 | V |
| $V_{S,UVLOF}$ | $V_S$ 低電圧誤動作防止の立ち下がり | | | 4.1 | 4.5 | 4.85 | V |
| **VDS クランプ** | | | | | | | |


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 6.5 電気的特性 (続き)

$V_S$ = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)

| パラメータ | | テスト条件 | | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $V_{DS,Clamp}$ | $V_{DS}$ クランプ電圧 | FET 電流 = 10mA | $V_S$ = 24V | 64 | 75 | 81 | V |
| | | | $V_S$ = 6V | 48 | 53 | 58 | V |
| **Ron の特性** | | | | | | | |
| $R_{ON}$ | オン抵抗 | 0.5A ≤ $I_{OUT}$ ≤ 3A、$V_S$ = 6V ～ 60V | $T_J$ = 25°C | | 83 | | mΩ |
| | | | $T_J$ = 125°C | | | 168 | mΩ |
| | | | $T_J$ = 150°C | | | 180 | mΩ |
| $R_{ON(REV)}$ | 逆極性時のオン抵抗 | 0.5A ≤ $I_{OUT}$ ≤ 3A、$V_S$ = –24V | $T_J$ = –40℃ ～ 150℃ | | | 180 | mΩ |
| $R_{ON_AUX}$ | VS と VOUT のオン抵抗 高精度検出モード | $V_S$ = 24V、$I_{OUT}$ = 40mA OL_ON=DIAG_EN=5V | $T_J$ = –40℃ ～ 150℃ | | 4.7 | 12 | Ω |
| **電流制限特性** | | | | | | | |
| $K_{CL}$ | 電流制限比 | | $I_{CL, typ}$ = 5.26A | | 52.6 | | A × kΩ |
| | | | $I_{CL, typ}$ = 4.15A | | 51.9 | | A × kΩ |
| | | | $I_{CL, typ}$ = 3.04A | | 50.8 | | A × kΩ |
| | | | $I_{CL, typ}$ = 1.98A | | 49.5 | | A × kΩ |
| | | | $I_{CL, typ}$ = 0.96A | | 48 | | A × kΩ |
| $I_{LIM_STARTUP}$ | スイッチがイネーブルのときのピーク電流制限 (A バージョン) | | $R_{ILIM}$ = 10kΩ ～ 50kΩ | | 2 × $I_{CL}$ | 6.5 | A |
| $t_{LIM_STARTUP_DELAY}$ | デバイスが $I_{LIM_STARTUP}$ レベルを維持するまでの遅延時間 (A バージョン) | | | | | 12 | ms |
| $I_{CL}$ | 電流制限レベル | 短絡条件、$V_{DS}$ = 1V | $R_{ILIM}$ = 50kΩ | 0.73 | 0.96 | 1.11 | A |
| | | | $R_{ILIM}$ = 25kΩ | 1.5 | 1.98 | 2.3 | A |
| | | | $R_{ILIM}$ = 16.7kΩ | 2.3 | 3.04 | 3.5 | A |
| | | | $R_{ILIM}$ = 12.5kΩ | 3.15 | 4.15 | 4.77 | A |
| | | | $R_{ILIM}$ = 10kΩ | 4 | 5.26 | 6.3 | A |
| | | | $R_{ILIM}$ = GND、オープン、または範囲外 (<5kΩ、および >150kΩ) | 0.35 | 0.48 | 0.6 | A |
| $I_{CL_LINPK}$ | 過電流制限スレッショルド (1) | 過負荷状態 | $R_{ILIM}$ = 25kΩ | | | 1.5 × $I_{CL}$ | A |
| $I_{CL_ENPS}$ | 永久短絡を有効化するピーク電流 | | $R_{ILIM}$ = 50kΩ | | | 4 × $I_{CL}$ | A |
| | | | $R_{ILIM}$ = 25kΩ | | | 3.3 × $I_{CL}$ | A |
| | | | $R_{ILIM}$ = GND への短絡 | | | 5.7 × $I_{CL}$ | A |
| $I_{CL_ENPS2}$ | 永久短絡を有効化するピーク電流 | | $R_{ILIM}$ = 10kΩ、t < $I_{LIM_STARTUP_DELAY}$ | | | 2 × $I_{LIM_STARTUP}$ | A |
| $t_{IOS}$ | 短絡応答時間 | VS = 24V | | | 0.5 | | µs |
| **サーマル シャットダウンの特性** | | | | | | | |
| $T_{ABS}$ | サーマル シャットダウン | | | 165 | 185 | | °C |
| $T_{REL}$ | 相対サーマル シャットダウン | | | | 77 | | °C |
| $t_{RETRY}$ | 再試行時間 (2) | フォルト・シャットダウンからスイッチ再有効化 (サーマル シャットダウン) までの時間。 | | | 2 | | ms |
| フォルト応答 | サーマル シャットダウンへのフォルト応答 | | | | 自動再試行 | | |

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 6.5 電気的特性 (続き)

$V_S$ = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)

| パラメータ | | テスト条件 | | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T_{HYS}$ | 絶対サーマル シャットダウン ヒステリシス | | | | 10 | | ℃ |
| **フォルト ピンの特性** | | | | | | | |
| $V_{FAULT}$ | $\overline{FAULT}$ low 出力電圧 | $I_{\overline{FAULT}}$ = 2.5mA | | | | 0.5 | V |
| $t_{FAULT_BLANKING}$ | 起動中のフォルト ブランキング時間 (A および B バージョン) | | $V_{DIAG_EN}$ = 5V、$V_{EN}$ = 0 ～ 5V | | | 12 | ms |
| $t_{FAULT_FLT}$ | フォルト表示時間 | フォルトと $\overline{FAULT}$ アサート間の時間 | | | | 75 | µs |
| $t_{FAULT_SNS}$ | フォルト表示時間 | $V_{DIAG_EN}$ = 5V 、フォルトと $V_{SNSFH}$ における $I_{SNS}$ セトリング間の時間 | | | | 106 | µs |
| **電流センス特性** | | | | | | | |
| $I_{KSNS2_EN}$ | $K_{SNS}$ モードでの $K_{SNS2}$ 有効化のための負荷電流をサポート | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V、$V_{OL_ON}$ = GND | | 21 | 25 | 30 | mA |
| $I_{KSNS2_DIS}$ | $K_{SNS2}$ モードでの $K_{SNS2}$ 無効化のための負荷電流 | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V、$V_{OL_ON}$ = GND | | 75 | 85 | 105 | mA |
| $K_{SNS1}$ | 電流センス比 - 標準センシング $I_{OUT}$ / $I_{SNS}$ | $I_{OUT}$ = 1A、$V_{OL_ON}$ = GND | | | 800 | | A/A |
| $K_{SNS2}$ | 電流センス比 - 高精度センシング $I_{OUT}$ / $I_{SNS}$ | $I_{OUT}$ = 20mA、$V_{OL_ON}$ = 5V | | | 24 | | A/A |
| $I_{SNS}$ | 電流センス電流 | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V、$V_{OL_ON}$ = GND | $I_{OUT}$ = 4A | | 5 | | mA |
| | | | | -4 | | 6 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 3.5A | | 4.375 | | mA |
| | | | | -4 | | 4 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 3A | | 3.75 | | mA |
| | | | | -4 | | 4 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 2A | | 2.5 | | mA |
| | | | | -4 | | 4 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 1A | | 1.25 | | mA |
| | | | | -4 | | 4 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 0.75A | | 0.9375 | | mA |
| | | | | -6 | | 6 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 0.5A | | 0.625 | | mA |
| | | | | -6 | | 6 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 250mA | | 0.3125 | | mA |
| | | | | -10 | | 10 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 150mA | | 0.1875 | | mA |
| | | | | -10 | | 10 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 60mA | | 0.075 | | mA |
| | | | | -25 | | 25 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 30mA | | 0.0375 | | mA |
| | | | | -25 | | 25 | % |


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 6.5 電気的特性 (続き)

$V_S$ = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)

| パラメータ | | テスト条件 | | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_{SNS2}$ | 高精度センス モードに適した、電流センス電流と精度 | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V、$V_{OL_ON}$ = 5V | $I_{OUT}$ = 20mA | | 0.833 | | mA |
| | | | | -6 | | 6 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 10mA | | 0.404 | | mA |
| | | | | -10 | | 10 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 4mA | | 0.161 | | mA |
| | | | | -12.5 | | 12.5 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 2mA | | 0.0800 | | mA |
| | | | | -15 | | 15 | % |
| | | | $I_{OUT}$ = 1mA | | 0.0395 | | mA |
| | | | | -20 | | 20 | % |
| **SNS ピンの特性** | | | | | | | |
| $V_{SNSFH}$ | $V_{SNS}$ フォルト high-レベル | $V_{DIAG_EN}$ = 5V | | 4.5 | 5 | 5.77 | V |
| | | $V_{DIAG_EN}$ = 3.3V、$R_{SNS}$ = オープン | | 3.3 | 3.95 | 4.4 | V |
| | | $V_{DIAG_EN}$ = $V_{IH}$ | | 2.9 | 3.2 | 3.5 | V |
| $I_{SNSFLT}$ | $I_{SNS}$ フォルト high-レベル | $V_{DIAG_EN}$ > $V_{IH,\ DIAG_EN}$ | | 5.2 | 6.4 | | mA |
| $I_{SNSleak}$ | $I_{SNS}$ リーケージ | $V_{DIAG_EN}$ = 5V、IL = 0mA | | | | 1.3 | µA |
| $V_{S_ISNS}$ | フル電流センスとフォルト機能用 $V_S$ | $V_{DIAG_EN}$ = 3.3V | | 5.9 | | | V |
| | | $V_{DIAG_EN}$ = 5V | | 7.1 | | | V |
| **開放負荷検出の特性** | | | | | | | |
| $V_{OL_OFF}$ | オフ状態での開放負荷 (OL) 検出電圧 | $V_{EN}$ = 0V、$V_{DIAG_EN}$ = 5V | | 1.4 | 2 | 2.6 | V |
| $R_{OL_OFF}$ | オフ状態での開放負荷 (OL) 検出における内部プルアップ抵抗 | $V_{EN}$ = 0V、$V_{DIAG_EN}$ = 5V | $V_S$ = 6V | 110 | 133 | 150 | kΩ |
| | | | $V_S$ = 24V | 114 | 140 | 166 | kΩ |
| | | | $V_S$ = 48V | 120 | 140 | 166 | kΩ |
| $t_{OL_OFF}$ | オフ状態での開放負荷 (OL) 検出グリッチ除去時間。 | $V_{EN}$ = 0V、$V_{DIAG_EN}$ = 5V、Vs - $V_{OUT}$ < $V_{OL}$ のとき、$t_{OL}$ よりも長い持続時間。開放負荷検出。 | | | 480 | 1050 | µs |
| $t_{OL_OFF_1}$ | EN 立ち下がりからの OL_OFF および STB 表示時間 | $V_{EN}$ = 5V ～ 0V、$V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$I_{OUT}$ = 0mA、$V_{OUT}$ = Vs - $V_{OL}$ | | | 310 | 905 | µs |
| $t_{OL_OFF_2}$ | DIA_EN 立ち上がりからの OL および STB 表示時間 | $V_{EN}$ = 0V、$V_{DIAG_EN}$ = 0V ～ 5V<br>$I_{OUT}$ = 0mA、$V_{OUT}$ = $V_S$ - $V_{OL}$ | | | | 1080 | µs |
| **OL_ON ピンの特性** | | | | | | | |
| $V_{IL,\ OL_ON}$ | 低レベルの入力電圧 | | | | | 0.8 | V |
| $V_{IH,\ OL_ON}$ | 高レベルの入力電圧。 | | | 1.5 | | | V |
| $V_{IHYS,\ OL_ON}$ | 入力電圧ヒステリシス | | | | 282 | | mV |
| $R_{OL_ON}$ | 内部プルダウン抵抗。 | | | 0.7 | 1 | 1.3 | MΩ |
| $I_{IL_OL_ON}$ | 低レベルの入力電流 | $V_{OL_ON}$ = –1V | | -25 | | 0 | µA |
| $I_{IL,\ OL_ON}$ | 低レベルの入力電流 | $V_{OL_ON}$ = 0.8V | | 0.6 | .8 | 1.2 | µA |
| $I_{IH,\ OL_ON}$ | 高レベルの入力電流 | $V_{OL_ON}$ = 5V | | 3 | 5 | 7 | µA |
| **DIAG_EN ピンの特性** | | | | | | | |
| $V_{IL,\ DIAG_EN}$ | 低レベルの入力電圧 | GND ネットワークなし | | | | 0.8 | V |
| $V_{IH,\ DIAG_EN}$ | 高レベルの入力電圧。 | GND ネットワークなし | | 1.5 | | | V |

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 6.5 電気的特性 (続き)

$V_S$ = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)

| パラメータ | | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $V_{IHYS,DIAG_EN}$ | 入力電圧ヒステリシス | | | 270 | | mV |
| $R_{DIAG_EN}$ | 内部プルダウン抵抗。 | | 200 | 350 | 500 | kΩ |
| $I_{IL,DIAG_EN}$ | 低レベルの入力電流 | $V_{EN}$ = 0.8V、$V_{DIAG_EN}$ = 0V | | 2.9 | | µA |
| $I_{IH,DIAG_EN}$ | 高レベルの入力電流 | $V_{DIAG_EN}$ = 5V | | 14 | | µA |
| **EN ピンの特性** | | | | | | |
| $V_{IL,EN}$ | 低レベルの入力電圧 | GND ネットワークなし | | | 0.8 | V |
| $V_{IH,EN}$ | 高レベルの入力電圧。 | GND ネットワークなし | 1.5 | | | V |
| $V_{IHYS,EN}$ | 入力電圧ヒステリシス | | | 300 | | mV |
| $R_{EN}$ | 内部プルダウン抵抗。 | | 200 | 350 | 500 | kΩ |
| $I_{IL,EN}$ | 低レベルの入力電流 | $V_{EN}$ = 0.8V | | 2.2 | | µA |
| $I_{IH,EN}$ | 高レベルの入力電流 | $V_{EN}$ = 5V | | 14 | | µA |

(1) 電流制限レギュレーション前の過負荷状態での最大電流出力。
(2) 量産品のデータはテストしていません。

## 6.6 SNS タイミング特性

$V_S$ = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)、パラメータは出荷時のテストは行っていません

| パラメータ | | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SNS タイミング-電流センス** | | | | | | |
| $t_{SNSION1}$ | DIAG_EN の立ち上がりエッジからのセトリング タイム<br>DIAG_EN の 50% から安定状態 ISNS の 90% まで | $V_{EN}$= 5V、$V_{DIAG_EN}$ = 0V ～ 5V、<br>$V_{OL_ON}$ = 0V、<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 1A | | | 15 | µs |
| | | $V_{EN}$ = 5V、$V_{DIAG_EN}$ = 0V ～ 5V、<br>$V_{OL_ON}$ = 0V、<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 50mA | | | 80 | µs |
| $t_{SNSION2}$ | EN および DIAG_EN の立ち上がりエッジからのセトリング タイム<br>$V_{DIAG_EN}$ $V_{EN}$ の 50% から安定状態 ISNS の 90% まで | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 0V ～ 5V<br>$V_S$ = 24V $R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 1A | | | 200 | µs |
| $t_{SNSION3}$ | EN の立ち上がりエッジからのセトリング タイム<br>$V_{EN}$ の 50% から安定状態 ISNS の 90% まで | $V_{EN}$ = 0V ～ 5V、$V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 1A | | | 200 | µs |
| $t_{SNSION4}$ | OL_ON の立ち上がりエッジからのセトリング タイム<br>$V_{OL_ON}$ の 50% から安定状態 ISNS の 90% まで | $V_{OL_ON}$ = 0 ～ 5V、$V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 6mA | | | 60 | µs |
| $t_{SNSION5}$ | $I_L$ < $I_{KSNS2_EN}$ の立ち下がりエッジから安定状態 ISNS の 90% までのセトリング タイム | $V_{OL_ON}$ = $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 100mA ～ 10mA | | | 60 | µs |
| $t_{SNSION6}$ | $I_L$ > $I_{KSNS2_DIS}$ の立ち上がりエッジからのセトリング タイム。安定状態 ISNS の 90% まで | $V_{OL_ON}$ = $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 10mA ～ 100mA | | | 60 | µs |
| $t_{KSNS2_DIS_DGL}$ | $I_L$ > $I_{KSNS2_DIS}$ 遷移のグリッチ除去時間。 | $V_{OL_ON}$ = $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_L$ = 10mA ～ 100mA | | | 30 | µs |
| $t_{SNSIOFF}$ | DIAG_EN の立ち下がりエッジのセトリング タイム | $V_{EN}$ = 5V、$V_{DIAG_EN}$ = 5V ～ 0V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$R_L$ = 48Ω | | | 20 | µs |


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 6.6 SNS タイミング特性 (続き)

$V_S$ = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)、パラメータは出荷時のテストは行っていません

| パラメータ | | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{SETTLEH}$ | 負荷ステップの立ち上がりエッジのセトリングタイム。<br>$V_{OL_ON}$ の 50% から 90% の安定状態 ISNS まで | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_{OUT}$ = 0.5A ～ 3A | | | 20 | µs |
| $t_{SETTLEL}$ | 負荷ステップの立ち下がりエッジからのセトリング タイム。<br>$V_{OL_ON}$ の 50% から 10% の安定状態 ISNS まで | $V_{EN}$ = $V_{DIAG_EN}$ = 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_{OUT}$ = 3A ～ 0.5A | | | 20 | µs |
| $t_{TIMEOUT}$ | VS-VOUT>2V による VSNSFH 表示までの時間。<br>EN、DIAG_EN、OL_ON の立ち上がりエッジ $V_{DIA_EN}$ $V_{EN}V_{OL_ON}$ の 50% から VSNSFH の立ち上がりエッジの 50% まで | $V_{DIAG_EN}$ = $V_{EN}$ = $V_{OL_ON}$ = 0V ～ 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_{OUT}$ = 5mA、$C_{OUT}$ = 50µF | | 245 | | µs |
| $t_{SNSFH}$ | SNSFH のアサート時間<br>VSNSFH の立ち上がりエッジの 50% から<br>VSNSFH の立ち下がりエッジの 50% から | $V_{DIAG_EN}$ = $V_{EN}$ = $V_{OL_ON}$ = 0V ～ 5V<br>$R_{SNS}$ = 1kΩ、$I_{OUT}$ = 5mA、$C_{OUT}$ = 15µF | 60 | | | µs |

## 6.7 スイッチング特性

VS = 6V ～ 60V、$T_A$ = –40℃ ～ 125℃ (特に記述のない限り)、$C_{OUT}$ = 22nF

| パラメータ | | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{DR}$ | ターンオン遅延時間 (遅延または診断から) | $V_S$ = 24V、$R_L$ = 48Ω EN の 50% ～ VOUT の 20% | | 17 | 45 | µs |
| $t_{DF}$ | ターンオフ遅延時間 | $V_S$ = 24V、$R_L$ = 48Ω EN の 50% ～ VOUT の 80% | 10 | 18 | 26 | µs |
| $SR_R$ | VOUT の立ち上がりスルーレート | $V_S$ = 24V、$V_{OUT}$ の 20% ～ 80%、$R_L$ = 48Ω | 2.3 | 3.6 | 4.6 | V/µs |
| $SR_F$ | VOUT の立ち下がりスルーレート | $V_S$ = 24V、$V_{OUT}$ の 80% ～ 20%、$R_L$ = 48Ω | 2.3 | 3.5 | 4.8 | V/µs |
| $t_{ON}$ | ターンオン時間 | $V_S$ = 24V、$R_L$ = 48Ω EN の 50% ～ VOUT の 80% | | 20 | 40 | µs |
| $t_{OFF}$ | ターンオフ時間 | $V_S$ = 24V、$R_L$ = 48Ω EN の 50% ～ VOUT の 20% | | 20 | 40 | µs |
| $t_{ON}$ - $t_{OFF}$ | ターンオン/ターンオフに対応 | 1ms のオン時間を持つスイッチ イネーブル パルス | -25 | | 70 | µs |
| $\Delta_{PWM}$ | PWM 精度 - 平均負荷電流 | 200µs のイネーブル パルス、$V_S$ = 24V、$R_L$ = 48Ω<br>F = $f_{max}$ | -15 | | 15 | % |

## 6.8 代表的特性

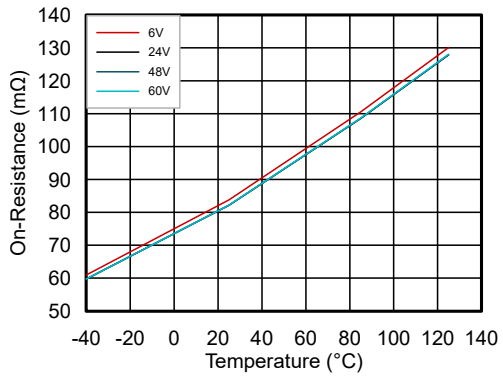
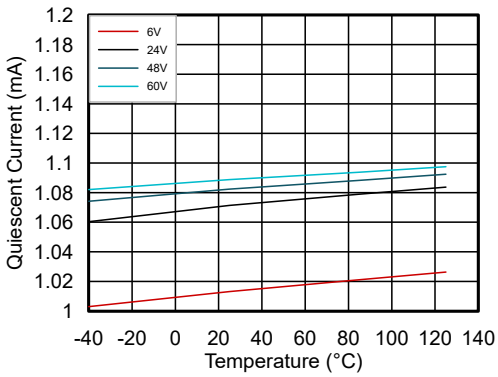
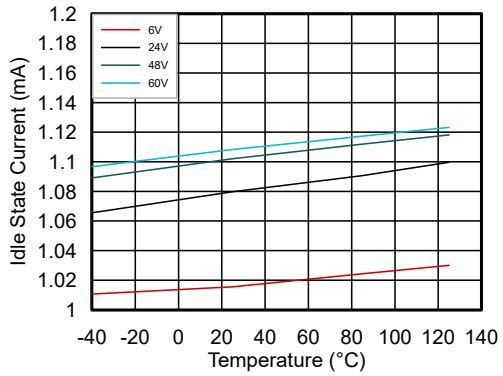



図 6-1. オン抵抗 ($R_{ON}$) と温度と VS 電源電圧との関係




$V_{EN}$ = 5V　　$V_{DIAG_EN}$ = 0V

図 6-2. VS 入力電源からの静止電流 ($I_{Q, VS}$) と温度と VS 電圧との関係




$V_{EN}$ = 0V　　$V_{DIAG_EN}$ = 0V

図 6-3. VS 入力電源からのアイドル状態電流 ($I_{IDLE, VS}$) と温度と VS 電圧との関係

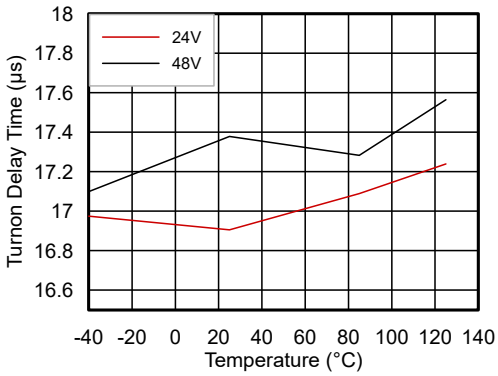



図 6-4. ターンオン遅延時間 ($t_{DR}$) と温度と VS 電圧との関係

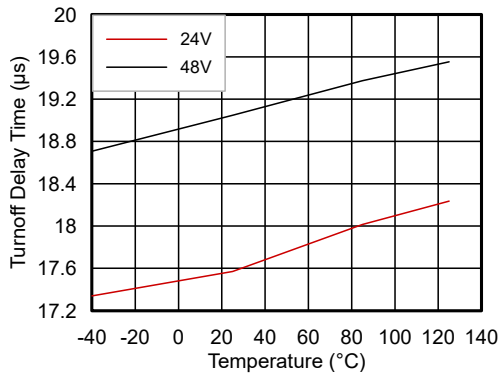



図 6-5. ターンオフ遅延時間 ($t_{DF}$) と温度と VS 電圧との関係

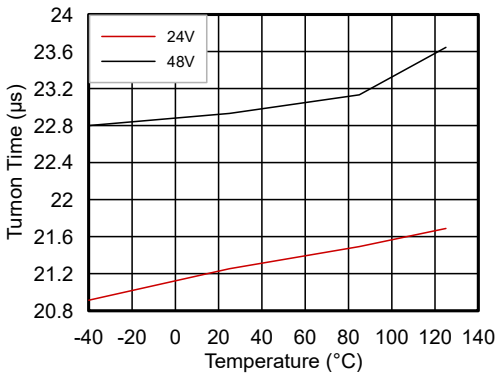



図 6-6. ターンオン時間 ($t_{ON}$) と温度と VS 電圧との関係


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 6.8 代表的特性 (続き)

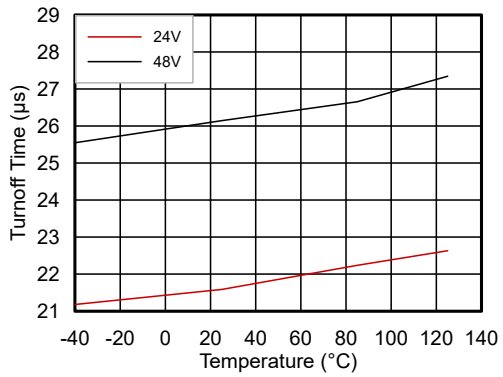



図 6-7. ターンオフ時間 ($t_{OFF}$) と温度と VS 電圧との関係

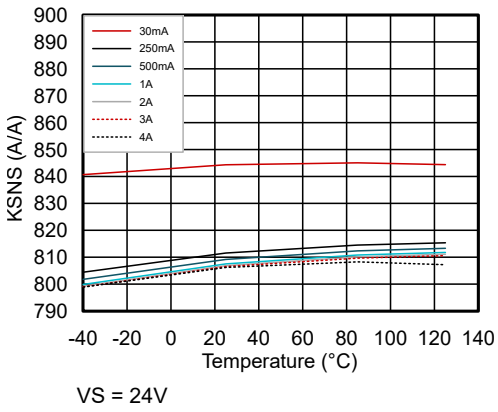



図 6-8. 電流センス比 (KSNS) と温度と負荷電流との関係

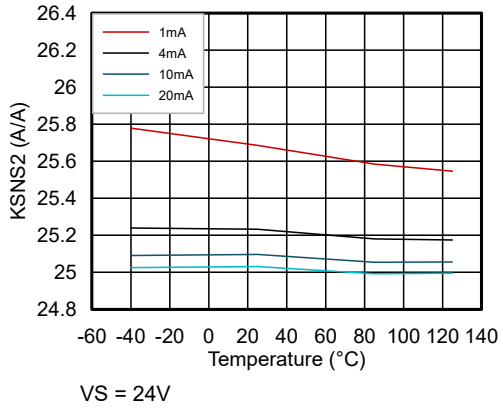



図 6-9. 電流センス比 ($KSNS_2$) と温度と負荷電流との関係

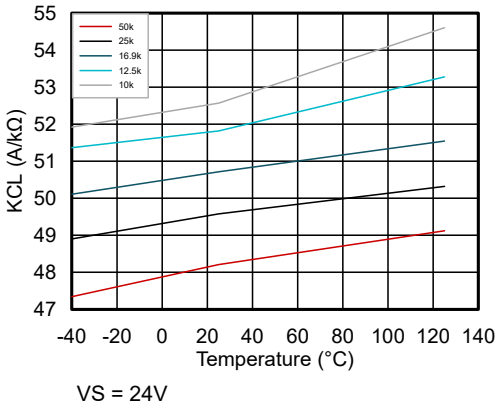



図 6-10. 電流制限比 ($K_{CL}$) と温度と $R_{ILIM}$ との関係

# 7 パラメータ測定情報

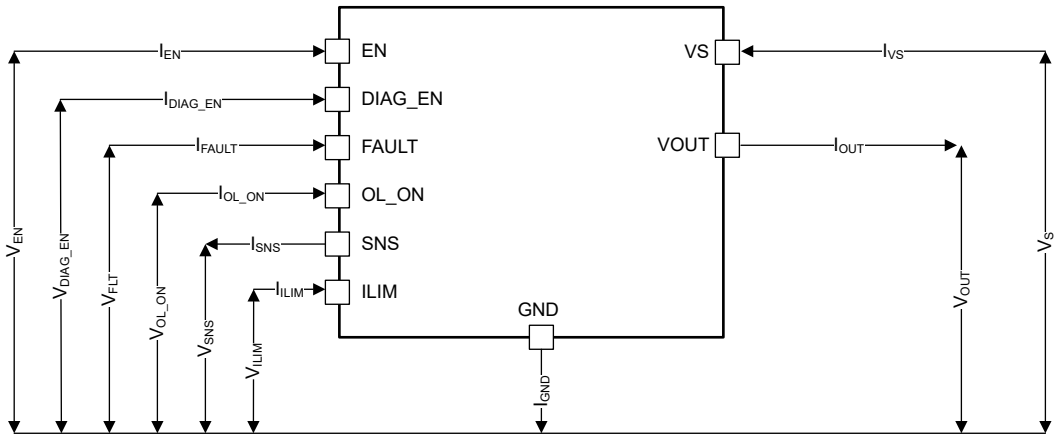
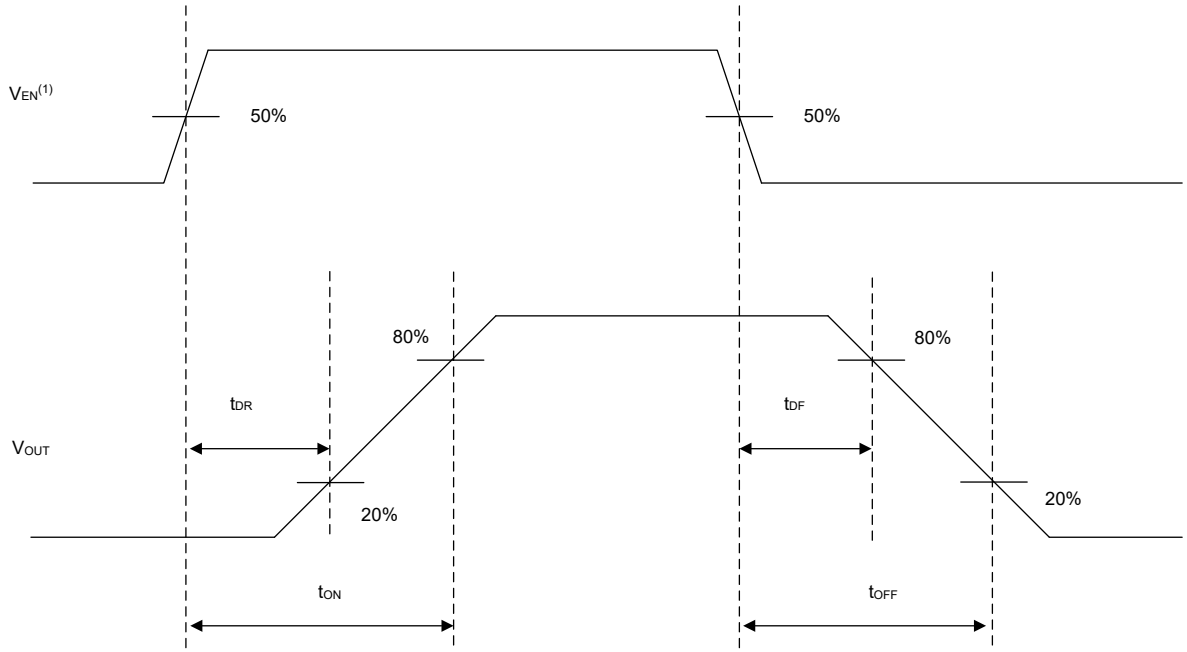


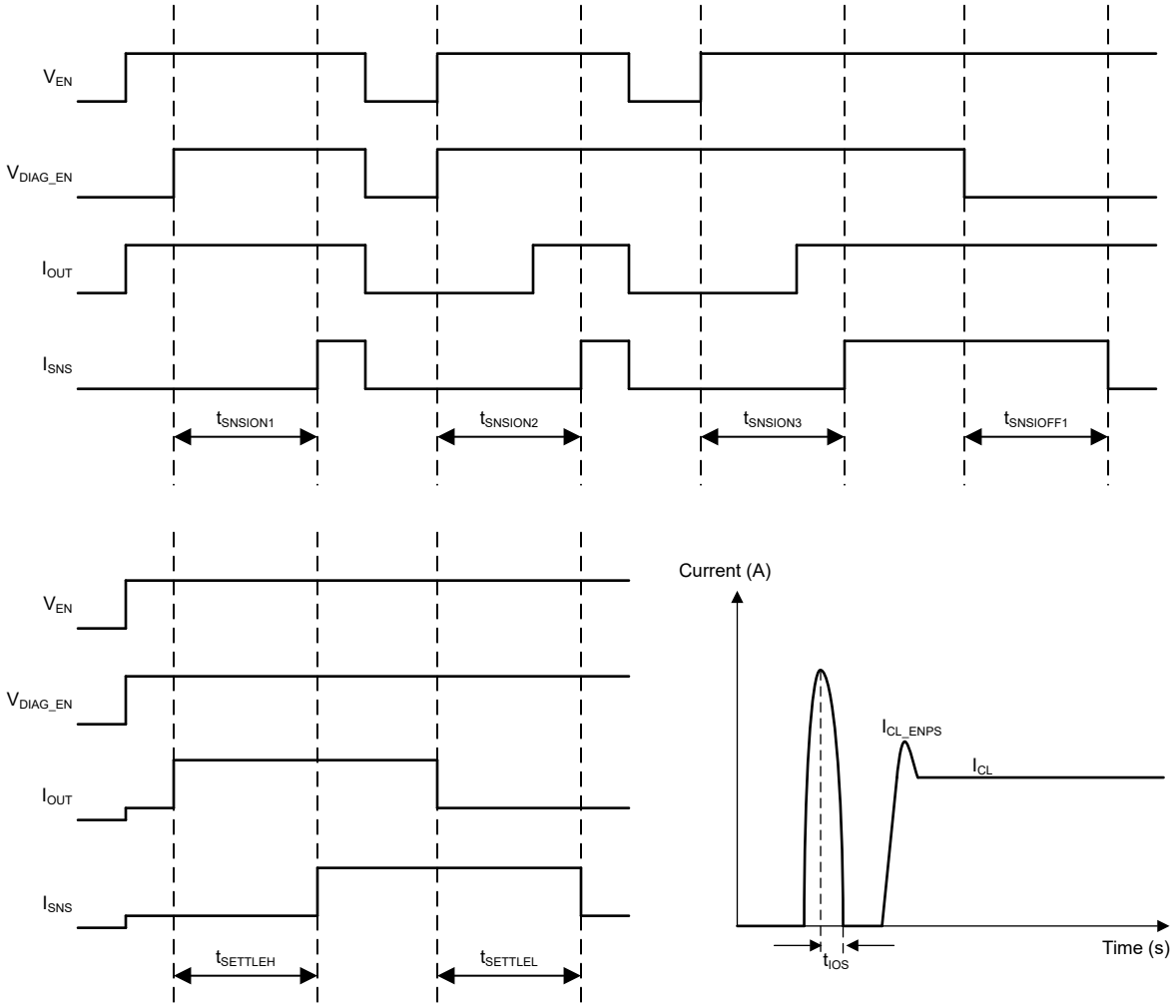

**図 7-1. パラメータの定義**




(1) $V_{EN}$ の立ち上がりおよび立ち下がり時間は 100ns です。

**図 7-2. スイッチング特性の定義**


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated




制御信号の立ち上がりおよび立ち下がり時間は 100ns です。制御信号には EN、DIA_EN があります。

**図 7-3. SNS のタイミング特性の定義**

# 8 詳細説明

## 8.1 概要

TPS281C100 はシングル チャネルの完全に保護されたハイサイド スイッチで、NMOS パワー FET およびチャージ ポンプが内蔵されています。包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。低ロジック高スレッショルド、$V_{IH}$、1.5V の入力ピンにより、マイコンを 1.8V までで使用できます。プログラマブル電流制限機能により、システム全体の信頼性が大幅に向上します。デバイス診断通知には 2 つのピンがあり、デジタル ステータスとアナログ電流センス出力の両方をサポートします。これらはいずれも、診断が無効のときにはハイ インピーダンス状態に設定できるため、デバイス間でマイコンのアナログまたはデジタル インターフェイスを多重化することが可能です。

デジタル ステータス レポートは、故障ピンのオープン ドレイン構造で実装されています。故障状態が発生した場合、ピンは GND にプルダウンされます。マイコンの電源レベルに合わせるのに、外部プルアップが必要です。高精度の電流検出により、キャリブレーションを追加することなく、さらに優れたリアルタイム監視効果と高精度の診断機能が実現されます。電流ミラーを使用して、負荷電流の 1 / $K_{SNS}$ がソースされ、これは SNS ピンの電圧として反映されます。$K_{SNS}$ は、温度と電源電圧に関係なく一定の値です。また、SNS ピンは、診断イネーブル電圧に応じて変化する $V_{SNSFH}$ の電圧を強制的に発生させることで、システムの ADC が検出する最大電圧が許容範囲内になるように、フォルトを報告することもできます。これにより、SNS ピンに外部のツェナー ダイオードまたは抵抗デバイダに対する必要性を改善します。

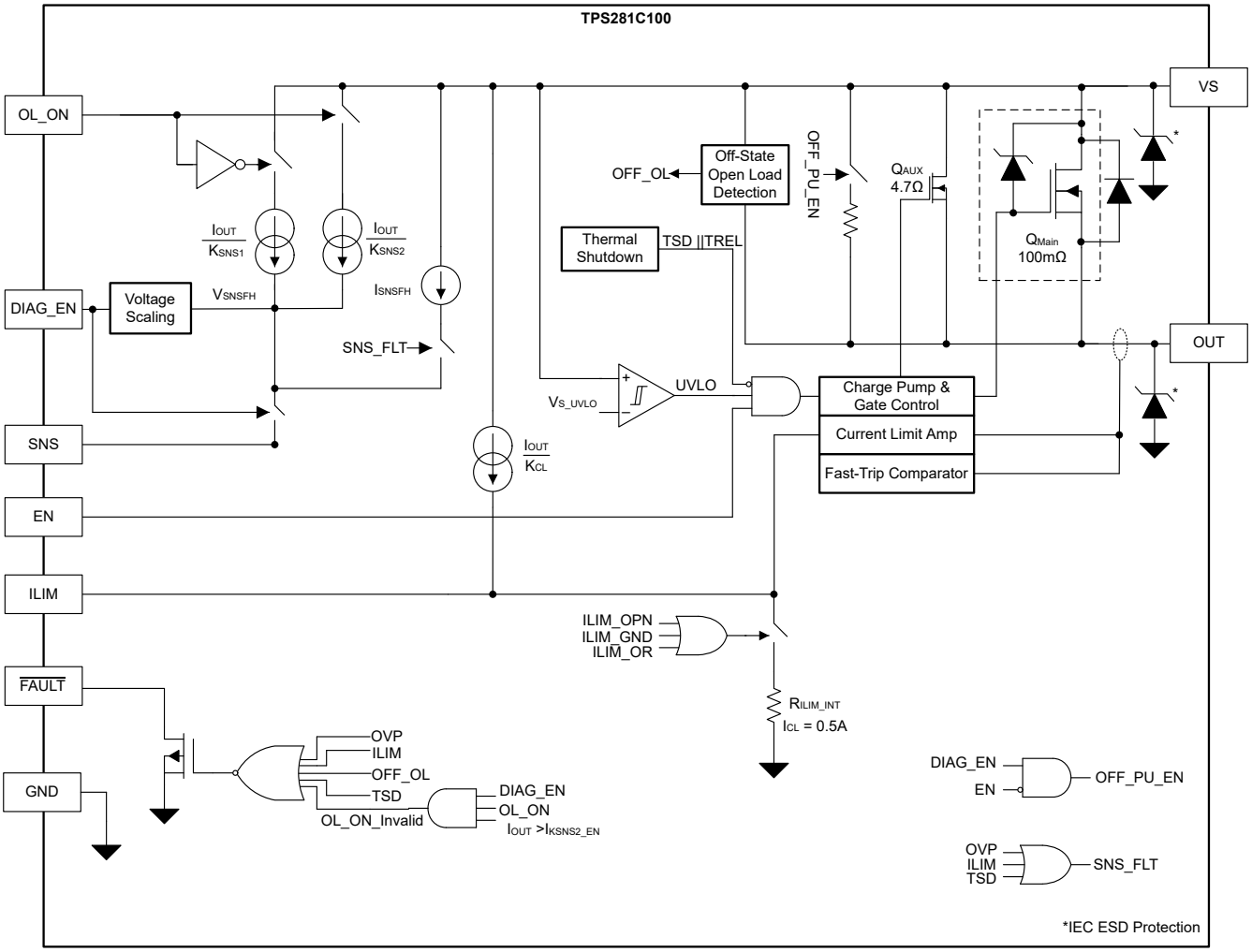
外部の高精度電流制限機能により、アプリケーションごとに電流制限値を設定できます。これは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。また、PCB パターン、コネクタ サイズ、および前段の電力容量を削減することで、システムのコストを節約できます。このデバイスには、内部電流制限も実装できます。外部または内部の電流制限値の低い方の値が適用されます。

リレー、ソレノイド、ポンプ、モーターなどの誘導性負荷のエネルギーをスイッチオフするため、電圧クランプをソースとするアクティブ ドレインが組み込まれています。誘電性のスイッチオフのサイクル中は、電源 ($E_{BAT}$) および負荷 ($E_{LOAD}$) の両方のエネルギーが、ハイサイド パワー スイッチ自体で消費されます。プロセス技術と優れた IC レイアウトによって TPS281C100x デバイスは優れたエネルギー消費能力を発揮でき、これによりほとんどの場合に外部のフリーホイール回路が不要になります。

TPS281C100x デバイスは、省電力電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド パワー スイッチとして使用できます。


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## 8.2 機能ブロック図




## 8.3 デバイスの機能モード

## 8.4 作業モード

デバイスには、通常モード、診断機能付き通常モード、アイドル モード、診断機能付きアイドル モードの 4 つの動作モードがあります。

通常モードは、EN が High で DIAG_EN が Low のときになります。このモードでは、VS は $I_{Q,VS}$ の静止電流を持ち、メイン FET がオンになります。DIAG_EN が Low の場合、SNS ピンで電流センス情報は利用できません。

診断機能付き通常モードは、EN と DIAG_EN の両方が High のときになります。このモードでは、VS は $I_{Q,VS_DIAG}$ の静止電流を持ち、メイン FET がオンになります。DIAG_EN が High の場合、電流センス情報を SNS ピン経由で利用できます。

アイドル モードは、EN と DIAG_EN の両方が Low のときになります。このモードでは、メイン FET がオフで、VS は $I_{IDLE,VS}$ の電流を消費します。この状態では、EFT 検出回路がアクティブになっているため、従来のシャットダウン状態に比べて余分な電流が消費されます。また、出力には常に電流シンクが動作しており、出力電圧を 0V 付近に維持します。出力シンクは、最大 $I_{OUT(OFF,SINK)}$ までシンクできます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

診断機能付きアイドル モードは、EN が Low で DIAG_EN が High のときになります。このモードでは、メイン FET がオフになり、VS は $I_{IDLE,VS_DIAG}$ の電流を消費します。DIAG_EN が High の場合、出力プルアップ回路が開放負荷および VS への短絡検出のためにアクティブになり、アクティブな出力シンクはありません。

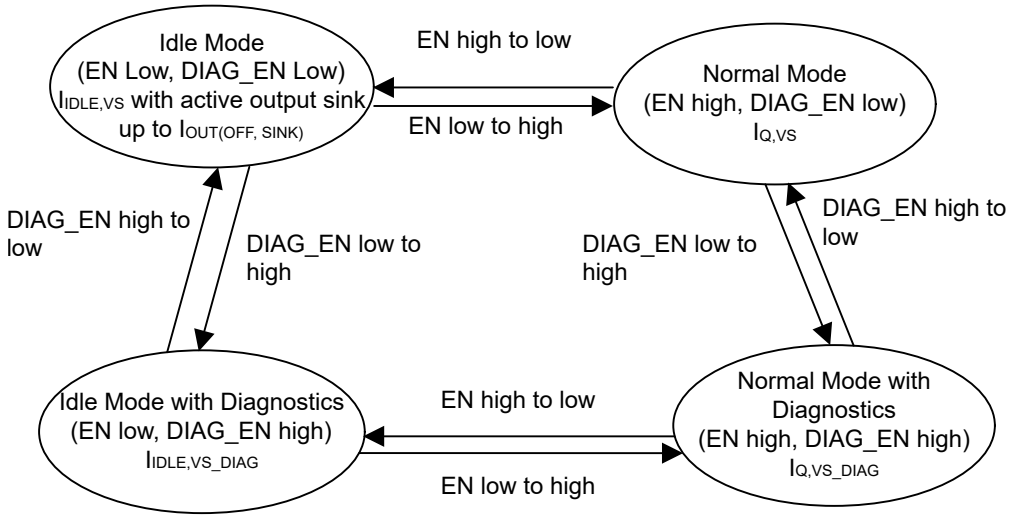



**図 8-1. 動作モードのステート マシン**

## 8.5 機能説明

### *8.5.1 高精度電流センス*

電流センスを内部に実装することにより、キャリブレーションを追加することなく、より優れたリアルタイム監視効果と高精度の診断機能を得ることができます。電流ミラーを使用して負荷電流の 1 / $K_{SNS}$ を調達し、SNS ピンと GND の間の外部抵抗に流して、SNS ピンの電圧として反映させます。

$K_{SNS}$ は、出力電流とセンス電流との比です。電気的特性に記載されている $K_{SNS}$ の精度は、温度と電源電圧を考慮した値です。各デバイスは製造時に内部で校正されているため、ほとんどの場合、ユーザーによる後校正は必要ありません。

SNS ピンの最大出力電圧は、フォルト電圧レベルである $V_{SNSFH}$ にクランプされます。この電圧がシステムの許容電圧を超えないように、TI は DIAG_EN ピンの電圧を SNS ピンの最大電圧に制限しています。DIAG_EN が $V_{IH}$ と 3.3V の間であれば、SNS ピンの最大出力は約 3.3V です。ただし、DIAG_EN の電圧が 3.3V を上回る場合、フォルト SNS 電圧 $V_{SNSFH}$ は、最大 5V までの電圧に追従します。DIAG_EN を通じて診断に電力を供給する GPIO 電圧出力が同じマイコン内の許容最大 ADC 電圧に近いため、これが行われます。そのため、センス抵抗値、$R_{SNS}$ を選択して、システムで測定すべき電流範囲を最大化します。$R_{SNS}$ の値は、アプリケーションの必要性に基づいて選択します。使用可能な $R_{SNS}$ の最大値が、システムで測定する必要がある最小の負荷電流 $I_{LOAD,min}$ である場合、ADC の最小許容電圧 $V_{ADC,min}$ によって制限されます。システムがフォルトを判定できるように、許容できる $R_{SNS}$ の最小値は、$V_{SNS}$ 電圧が $V_{SNSFH}$ 値より低くなるようにする必要があります。SNS ピンを流れる最大読み取り可能電流、$I_{LOAD,max}$ × $R_{SNS}$、$V_{SNSFH}$ との差をヘッドルーム電圧 $V_{HR}$ と呼びます。このシステムはヘッドルーム電圧を決定しますが、読み取り可能な最大電流と故障状態との間に差があることが重要となります。したがって、RSNS の最小値は、$V_{SNSFH}$ から $V_{HR}$ を引き、検出電流比を掛け、$K_{SNS}$ をシステムが測定する必要のある最大負荷電流 $I_{LOAD,max}$ で割った値にする必要があります。式 1 は、この境界方程式です。

$$V_{ADC,min} \times K_{SNS} / I_{LOAD,min} \leq R_{SNS} \leq (V_{SNSFH} - V_{HR}) \times K_{SNS} / I_{LOAD,max} \quad (1)$$


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

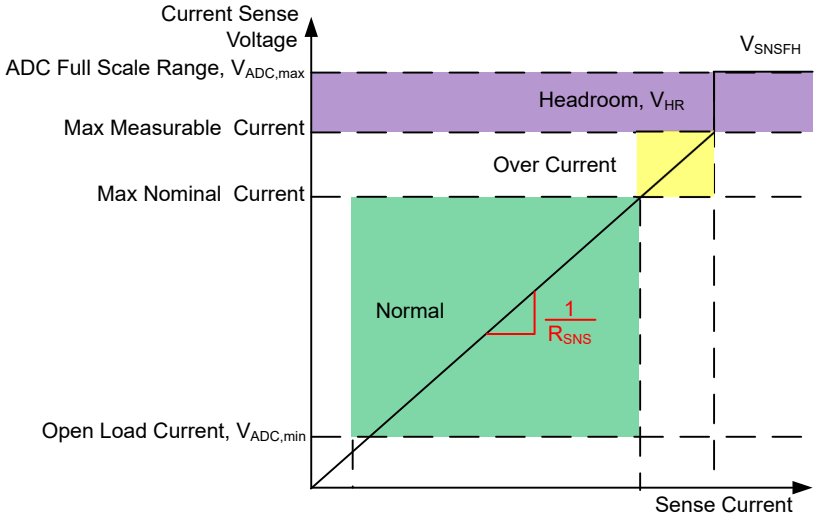



**図 8-2. 電流センスピンの電圧表示**

システムが読み取る最大電流 $I_{LOAD,max}$ は、電流制限スレッショルド以下とする必要があります。これは、電流制限スレッショルドをトリップすると、$V_{SNS}$ 値が $V_{SNSFH}$ になるためです。さらに、電流センス出力が飽和しないようにするため、測定対象の電流を 4A 未満にする必要があります。

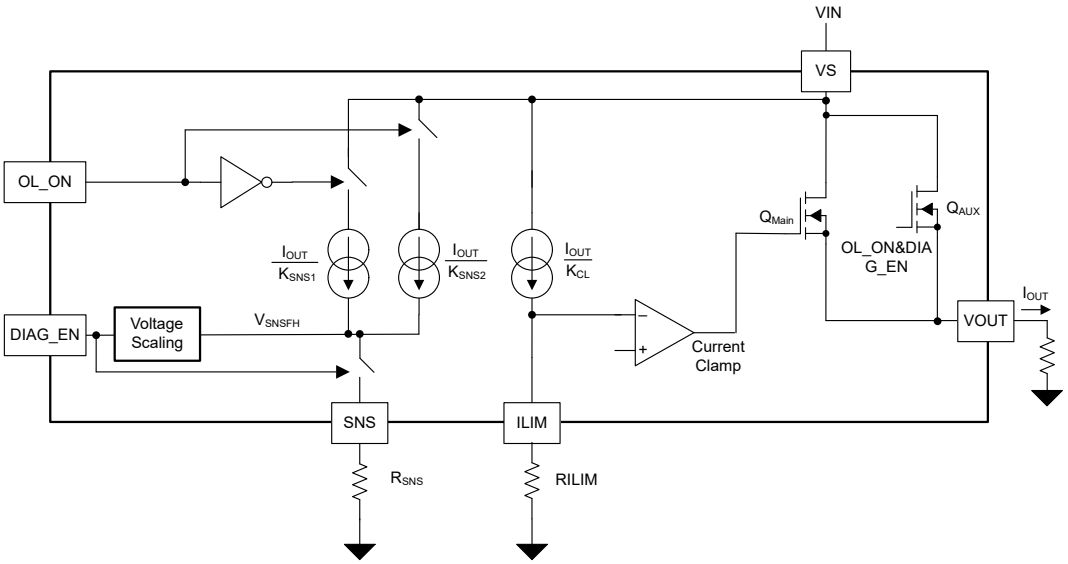



**図 8-3. 電流センスおよび電流制限のブロック図**

この方式は、マイコンから入力される電圧に基づいて適応するためです。高電圧から保護するために、SNS ピンにツェナー ダイオードを接続する必要はありません。

#### 8.5.1.1 高精度センス モード

一部のアプリケーションでは、実際の負荷と開放負荷条件 (断線) などのフォルト シナリオを区別するために、より小さい負荷電流で高精度電流検出を行うことが重要です。この課題に対処するために、TPS281C100 は高精度センス モードを実装しており、4mA 負荷時に±12.5% を達成できます。このモードは、診断が有効 (DIAG_EN = HI)、OL_ON = HI、$I_{Load}$<$I_{KSNS2_EN}$ の場合にアクティブになります。この高精度を実現するため、デバイスはメイン パスの抵抗値を増やしてセンス精度を向上させると同時に、高精度センシングがアクティブになります。TI は、負荷が 20mA を超えて増加し始めた場合には OL_ON = LO を設定して、この精度センス モードを無効化することを推奨します。これにより、消費電力が増加する状態を予防的に防止できます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

他のシナリオ (負荷の急激なステップなど) では、システムが SNS 出力電流の変化に反応するのに十分な速度を確保できない可能性があります。この場合、抵抗の増加によって与えられる高い電力消費状態を防止するためです。TPS281C100 は、VS から VOUT へのパスを流れる負荷が $I_{KSNS2_DIS}$ 未満であるかどうかを検出します。負荷が $I_{KSNS2_DIS}$ を超えると、FET 抵抗は最小抵抗に戻り、高精度センス モードは無効になります。そして、高精度センス モードが無効になったことを示すために $\overline{FAULT}$ がアサートされます。これにより、より高い負荷を駆動するときの消費電力が最小限になります。さらに、ユーザーは OL_ON ピンを PWM 制御することで、高抵抗モードを無効化し、電力損失をさらに最小限に抑えることができます。

しかし、デバイスによって精度が達成されたとしても、電流センス比によっては、システム ADC は、ADC が読み取る必要のある電圧が低いため、低い負荷電流を正確に測定するのに苦労する可能性があります。たとえば、電流センス比が 800、RSNS = 1kΩ を使用した場合、6mA $I_{Load}$ は約 7.5mV と表されます。10 ビット 5V ADC の場合、7.5mV の出力は 1LSB (4.88mV) をわずかに上回る値です。これにより、ADC でこの電流を正確に測定するのに十分なマージンが得られず、より高い分解能を使用しなければならない場合があります。

そのため、ADC の分解能要件を低く抑え、高精度センス モードで動作する際に低負荷電流を正確に検出できるように、TPS281C100 は電流センス比を 24 に下げています。センス比が 24 の場合、高精度センス モードで動作しているとき、6mA $I_{Load}$ は RSNS = 1kΩ を使用して 250mV として表されます。これは、同じ 10 ビット ADC では 51LSB に相当し、8 ビット ADC であっても、出力によって 12LSB を超えるヘッドルームが得られます。

完全なデバイス状態については、完全な保護と診断を参照してください。

**表 8-1. 電流検出動作モード**

| 条件 | EN | VOUT | OL_ON | KSNS | SNS | FAULT | 動作 | 復帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常<br>標準センシング | L | L | L | 800 | 0 | ハイ インピーダンス | 通常 | |
| | H | H | L | 800 | $I_{Load}$ / $K_{SNS}$ | ハイ インピーダンス | 通常 | |
| 高精度センス<br>通常動作 | H | H | H | 24 | $I_{Load}$ / $K_{SNS2}$ | ハイ インピーダンス | 高精度センシングのために低センス比を有効にし、有効な条件 $I_{Load}$<$I_{KSNS2_EN}$ が満たされているため、FAULT はハイ インピーダンスのままになります。 | |
| 高精度センス<br>無効な範囲 | H | H | H | 800 | $I_{Load}$ / $K_{SNS}$ | L | $I_{Load}$>$I_{KSNS2_DIS}$ であるため、FAULT がアサートされ、高精度センシングが有効でないことを通知します | 負荷が $I_{KSNS2_EN}$ を下回るか、OL_ON が LO にリセットされると、クリアされます。 |


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

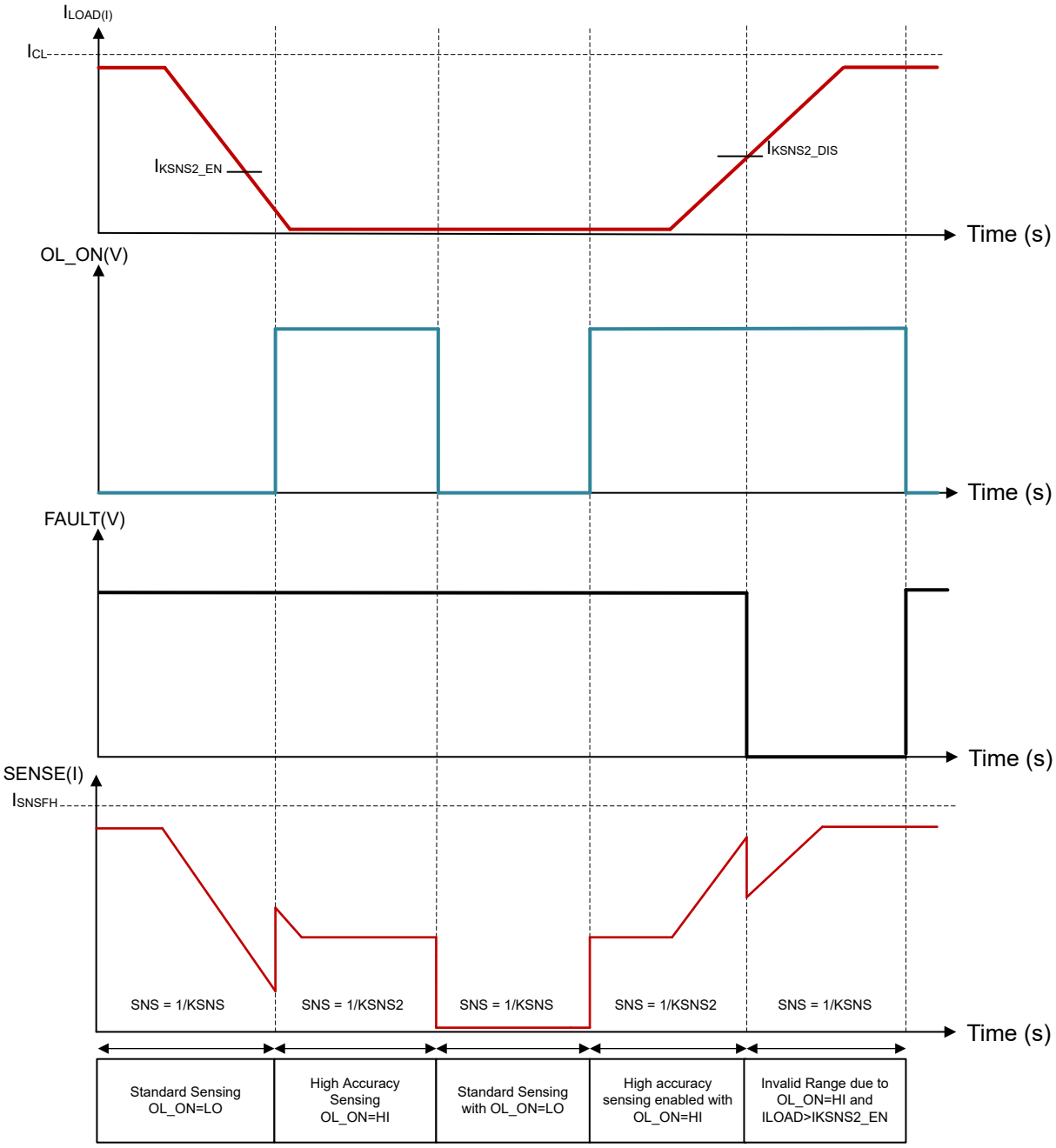



**図 8-4. 高精度センシング FAULT 表示**

### *8.5.2 電流制限をプログラム可能*

電流制限精度が高いため、信頼性が向上し、短絡や電源投入時に電源を保護できます。また、PCB パターン、コネクタサイズ、および先行する電力段を削減することで、システムのコストを節約できます。

電流制限は、過ストレスから負荷への保護と内蔵型パワー FET を実現します。電流制限は電流を設定値で保持し、SNS ピンを $V_{SNSFH}$ にプルアップして、診断レポートとして $\overline{FAULT}$ ピンをアサートします。2 つの電流制限スレッショルドは次のとおりです。

- 外部プログラマブル電流制限：外部抵抗 $R_{ILIM}$ を使用して、チャネル電流制限を設定します。デバイスを流れる電流が $I_{CL}$ (電流制限スレッショルド) を超えると、閉ループは即座にステップインします。それに従って $V_{GS}$ 電圧がレギュ

レートされ、$V_{DS}$ 電圧レギュレーションにつながります。閉ループが設定されると、電流は設定値にクランプされます。外部のプログラマブル電流制限機能により、アプリケーションごとに電流制限値を設定できます。

また、この値は、ILIM ピンの抵抗を変更することで動的に変更することもできます。この情報は「アプリケーション」セクションに記載されています。

- 内部電流制限：$I_{LIM}$ ピンがオープン、またはピンがグランドに短絡 — 外部電流制限が下限側の範囲外であるか、$I_{LIM}$ ピンがグランドに短絡している場合、内部電流制限は固定され、標準値は 0.5A です。これは、PCB のオーバーストレスによる短絡またはオープン接続による障害時の安全性電力制限メカニズムとして機能します。

$V_S$ に電力が供給され、EN が High のとき、内部電流制限 ($I_{lim,nom}$) と、外部プログラマブル電流制限の両方が常にアクティブになります。($I_{LIM}$ と外部プログラマブル電流制限値のうち) 低い方の値を用いて実際の電流制限値を設定します。電流制限のアサートに必要な標準グリッチ除去時間は 2.5µs です。

デバイスの GND と基板の GND の間にレベル シフトが生じるような GND ネットワークを使用する場合は、ILIM ピンをデバイスの GND に接続してください。式 2 を用いて、目的の標準的な $I_{CL}$ 値から $R_{LIM}$ を計算します。

$$R_{ILIM} = K_{CL}/I_{CL} \quad (2)$$

ここで計算される $R_{ILIM}$ の値は、電流制限の標準値に対応します。データシートに記載されている $R_{ILIM}$ 値については、電気的特性表に電流制限の最小値と最大値が記載されています。中間の $R_{ILIM}$ 値については、線形補間を用いて最小値と最大値を推定することができます。

電気的特性表に記載されている電流制限の最小値には、$\overline{FAULT}$ アサートの変動が含まれます。モジュールを設計する際に、$\overline{FAULT}$ 信号が通常動作中に発生しないことを確認するためには、最小電流制限値を通常動作電流よりも高くする必要があります。セクション 9.2.2.1 に、例を示します。

($V_S$ および入力が High で GND への短絡が突然発生した場合) GND への短絡を強力に保護するために、電流制限の閉ループが設定される前に、開ループ高速応答動作がチャネルをオフにするよう設定されます。この高速応答により、デバイスはより優れた突入抑制性能を実現できます。

#### 8.5.2.1 短絡および過負荷保護

TPS281C100 には出力短絡保護機能が備わっているため、GND への低インピーダンス パスが発生した場合にデバイスが電流の流れを防止し、損傷や深刻な電源ドループのリスクが排除されます。本デバイスは、ILIM ピンの状態や 125℃ の最大 60V 電源に関係なく、短絡イベントから保護するように規定されています。

図 8-5 に、短絡が発生して、デバイスがオン状態ですでに電流を出力しているときの TPS281C100 の動作を示します。内部パス FET が完全に有効になると、電流クランプ セトリング タイムが遅くなるため、オーバーシュートが制限されます。デバイスはレベル $I_{OVCR}$ で高速トリップ レベルを実装します。この高速トリップ スレッショルドに達すると、デバイスは短時間の間直ちにシャットオフされた後、すぐに再有効化され、短時間の過渡オーバーシュートの後、より高いピーク電流 ($I_{CL_ENPS}$) レベルまで電流が $I_{CL}$ レベルにクランプされます。その後、デバイスはサーマル シャットダウン温度に達するまで、レギュレーション電流制限でクランプされた電流を維持し、デバイスが安全にシャットオフされます。

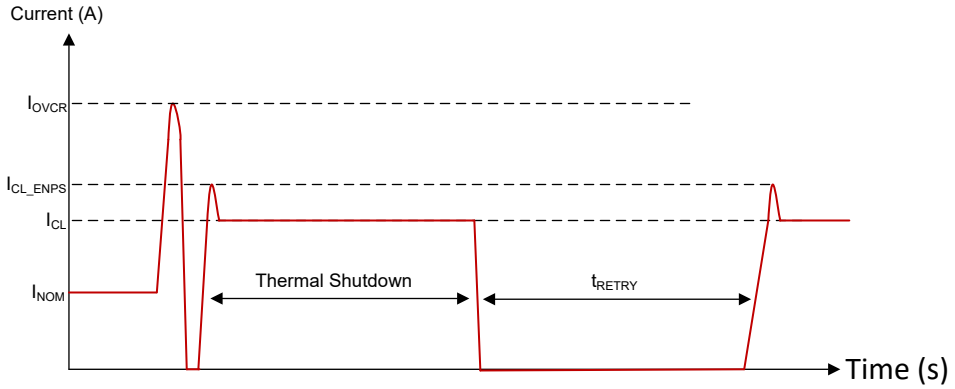



**図 8-5. オン状態の短絡動作**


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

図 8-6 に、$I_{CL}$ スレッショルドを上回る負荷電流を送信するインピーダンスがわずかに変化したときの TPS281C100 の動作を示します。電流は、レギュレーション レベルを超えて $I_{CL_LINPK}$ まで上昇します。その後、電流制限レギュレーション ループが始動し、電流は $I_{CL}$ の値まで低下します。

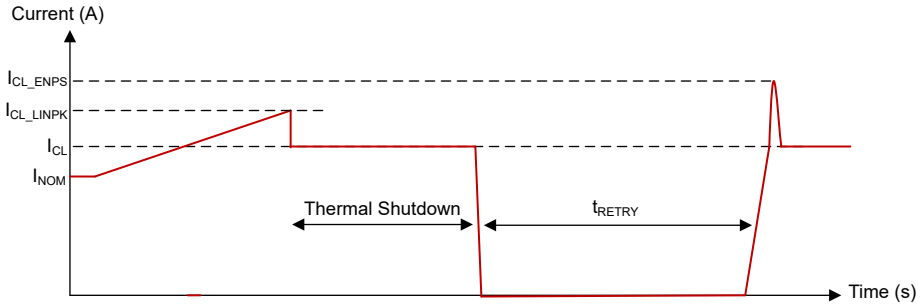



**図 8-6. 過負荷動作**

どのケースでも、内部サーマル シャットダウンに繰り返し達しても安全です。このサーマル シャットダウン レベルに繰り返し達しても、デバイスのリスクや寿命の信頼性に関する懸念はありません。

#### 8.5.2.2 容量性充電

容量性充電回路は、容量性負荷アプリケーションにおける代表的な設定と、デバイス使用時に機能する内部ブロックを示しています。すべての容量性負荷には、抵抗性負荷として説明されるコンデンサと並列に関連した「負荷」がありますが、実際には誘導性と抵抗性のいずれかになります。

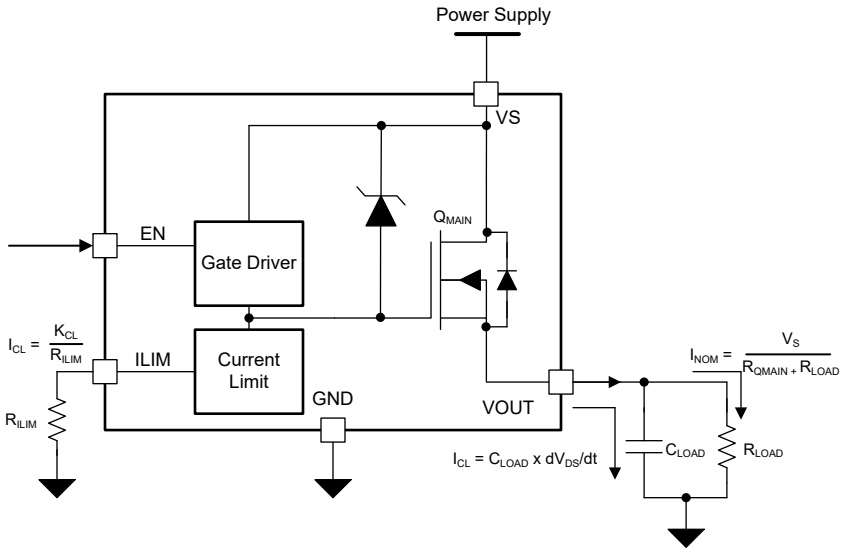



**図 8-7. 容量性充電回路**

最初に確認するのは、TPS281C100 デバイスで公称 DC 電流 $I_{NOM}$ が許容されることです。これは、「熱」セクションから $R_{\theta JA}$ を取得し、TPS281C100 の RON と INOM を乗算し、周囲温度を加算します。その値がサーマル シャットダウン値を下回っている場合、デバイスはその負荷電流で動作できます。この計算の例については、「アプリケーション」セクションを参照してください。

このアプリケーションに関する 2 番目の注意点は、デバイスがサーマル シャットダウンに達することなく、容量性負荷を完全に充電できるようにすることです。これは、充電中にデバイスがサーマル シャットダウンに達した場合、TPS281C100 がオフになっている間、キャパシタと並列の負荷の抵抗性特性がキャパシタの放電を開始するためです。負荷インピーダンスが十分高く、TPS281C100 がサーマル シャットダウンに達して再試行する一部のアプリケーションも許容されます。た

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

だし、大部分のアプリケーションでは、コンデンサの充電中に TPS281C100 がサーマル シャットダウンに達しないようにシステムを設計する必要があります。

TPS281C100 の電流制限機能により、他の高電流制限スイッチよりも低い突入電流でキャパシタを充電できます。突入電流が低いため、キャパシタが完全に充電されるまでに多少の時間がかかります。しかし、スタートアップ時の充電時間の増加を最小限に抑えるため、TPS281C100A は 図 8-8 に説明されているような突入電流処理機能を実装しています。EN ピンが High になってコンデンサをオンにすると、デバイスはデフォルトで、$I_{LIM_STARTUP_DELAY}$ の間、電流制限スレッショルドを $I_{LIM_STARTUP}$ に設定します。この遅延期間中は、標準値 $I_{CL}$ で許容される速度よりも高い容量性負荷を充電でき、FAULT がマスクされて望ましくないフォルト トリガを防止します。$I_{LIM_STARTUP_DELAY}$ の後、電流制限はデフォルトで $I_{CL}$ に戻り、Fault は通常動作します。

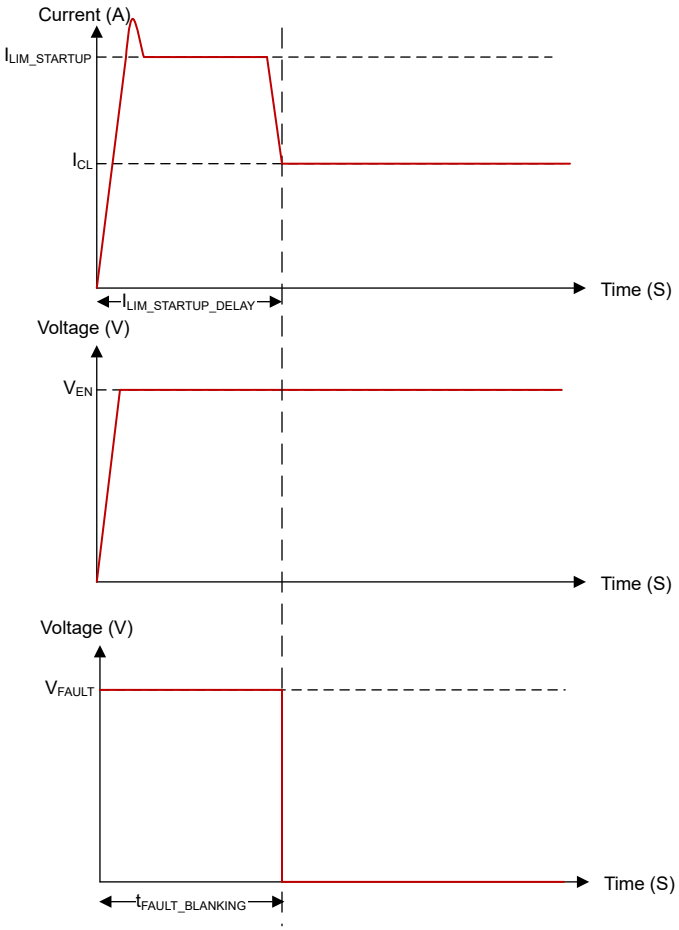



**図 8-8. 突入電流の処理**

電流制限が高いときの最初の突入電流期間により、負荷を駆動する際に 2 種類のシステム上の利点が実現されます。

- 白熱電球のような突入電流の大きい負荷を駆動するために、ミリ秒単位の期間、より高い負荷電流をサポートすることを可能にします。
- 高速な容量性負荷充電を可能にします。状況によっては、電源が素早く起動することを確認するために、DC 電流よりも大電流の容量性負荷を充電するのが最善です。このアーキテクチャにより、モジュールは最初の高い突入電流制限を使用して容量性負荷を迅速に充電し、その後、低い電流制限を使用して、過負荷または短絡の状況が発生したときにモジュールを確実に保護できます。


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

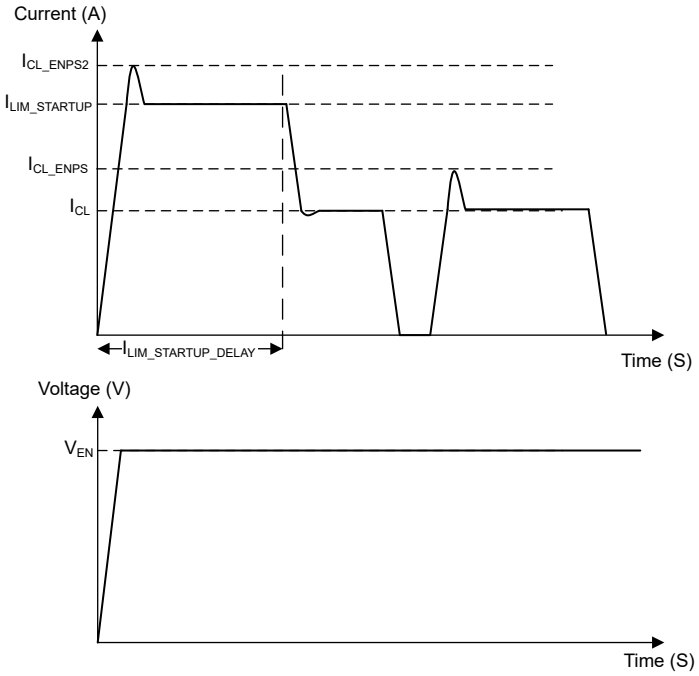



**図 8-9. ILIM_STARTUP_DELAY 前の自動再試行動作**

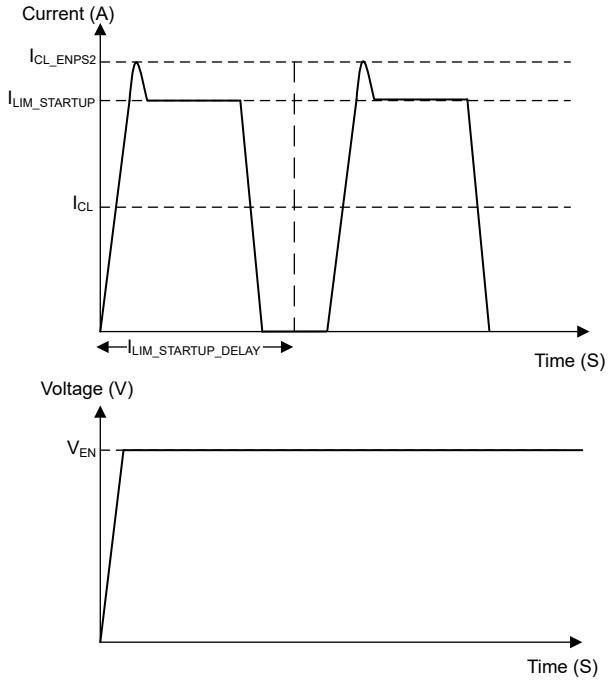



**図 8-10. ILIM_STARTUP_DELAY 後の自動再試行動作**

電流制限モードでは、どのレベルでも、デバイスの消費電力は大きくなります。FET 温度が過熱シャットダウン スレッショルドを超えると、デバイスは過負荷のチャネルのみをオフにします。冷却後、デバイスは再試行します。スタートアップ時にデバイスが早くオフになる場合は、PCB の熱レイアウトを改善したり、電流制限を下げて消費電力を低減したり、突入電流 (容量性負荷) を小さくしたりすることを推奨します。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

ハイサイド スイッチを使用した容量性充電の詳細については、『容量性負荷の駆動方法』アプリケーション ノートを参照してください。このアプリケーション ノートには、利用可能な熱モデルについての情報と、ハイサイド スイッチがコンデンサを特定の電圧まで充電できるかどうかを迅速に推定する方法が掲載されています。

### 8.5.3 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ

誘導性負荷がオフになると、インダクタンス特性により出力電圧は負にプルダウンされます。電流減衰期間中に電圧がクランプされない場合、パワー FET が壊れる可能性があります。このような状況でパワー FET を保護するために、ドレインとゲートの間にクランプ ダイオードを配置して、ドレインとソース間電圧、すなわち $V_{DS,clamp}$ を内部でクランプします。

$$V_{DS,Clamp} = V_S - V_{OUT} \quad (3)$$

電流減衰期間中 ($T_{DECAY}$)、インダクタンス-エネルギーを消費するためにパワー FET がオンになります。電源 ($E_S$) と負荷 ($E_{LOAD}$) の両方のエネルギーがハイサイド パワー スイッチ自体によって消費され、これは $E_{HSD}$ と呼ばれます。抵抗がインダクタンスと直列になっている場合は、負荷のエネルギーの一部が抵抗で消費されます。

$$E_{HSD} = E_S + E_{LOAD} = E_S + E_L - E_R \quad (4)$$

ハイサイド パワー スイッチ側から見ると、$E_{HSD}$ は電流減衰期間中の積分値に等しくなります。

$$E_{HSD} = \int_0^{T_{DECAY}} V_{DS,clamp} \times I_{OUT}(t)\, dt \quad (5)$$

$$T_{DECAY} = \frac{L}{R} \times \ln\left(\frac{R \times I_{OUT(MAX)} + |V_{OUT}|}{|V_{OUT}|}\right) \quad (6)$$

$$E_{HSD} = L \times \frac{V_{BAT} + |V_{OUT}|}{R^2} \times \left[R \times I_{OUT(MAX)} - |V_{OUT}| \ln\left(\frac{R \times I_{OUT(MAX)} + |V_{OUT}|}{|V_{OUT}|}\right)\right] \quad (7)$$

R がほぼ 0 に等しいとき、$E_{HSD}$ は以下で求められます。

$$E_{HSD} = \frac{1}{2} \times L \times I_{OUT(MAX)}^2 \frac{V_{BAT} + |V_{OUT}|}{R^2} \quad (8)$$

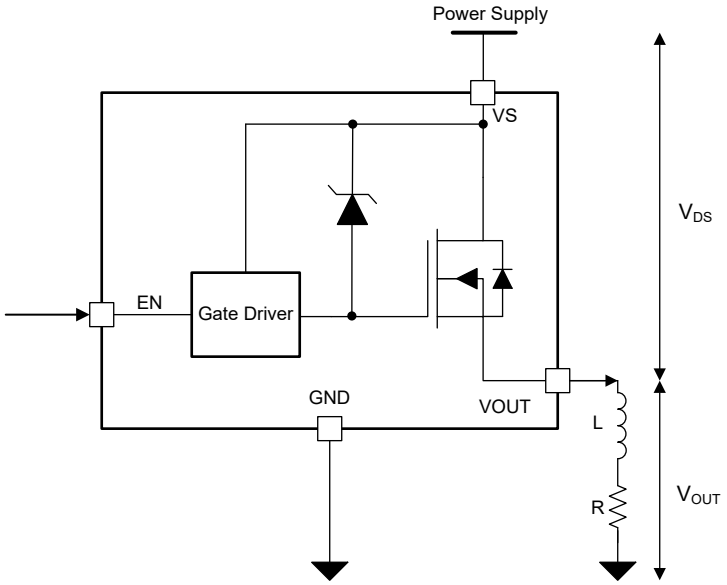



**図 8-11. 誘導性負荷の駆動**


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

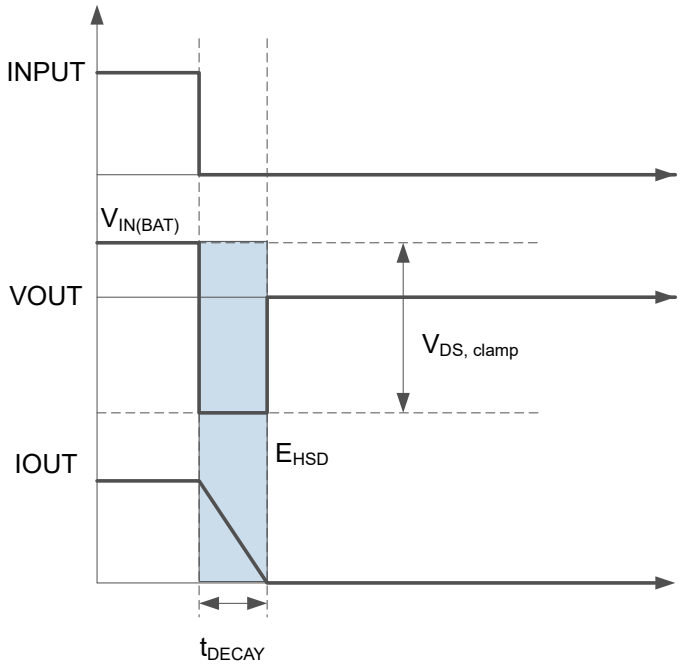



**図 8-12. 誘導性負荷のスイッチングオフ図**

前に述べたとおり、スイッチオフ時には、バッテリのエネルギーと負荷のエネルギーがハイサイド パワー スイッチで消費されるため、大きな熱変動が生じます。各ハイサイド パワー スイッチについて、安全な最大消費電力の上限は、デバイスの固有容量、周囲温度、および基板の放熱条件に依存します。

### *8.5.4 誘導性負荷の消磁*

誘導性負荷をオフにする際、インダクタによりスイッチの出力に負電圧が印加される場合があります。TPS281C100 は、VS と VOUT の間の電圧クランプを備えており、FET の両端の電圧を制限し、負荷インダクタンスがある場合は消磁します。OUT ピンに負の電圧が印加されることにより、インダクタ電流の放電が駆動されます。図 8-13 に、400mH 負荷を放電するデバイスを示します。

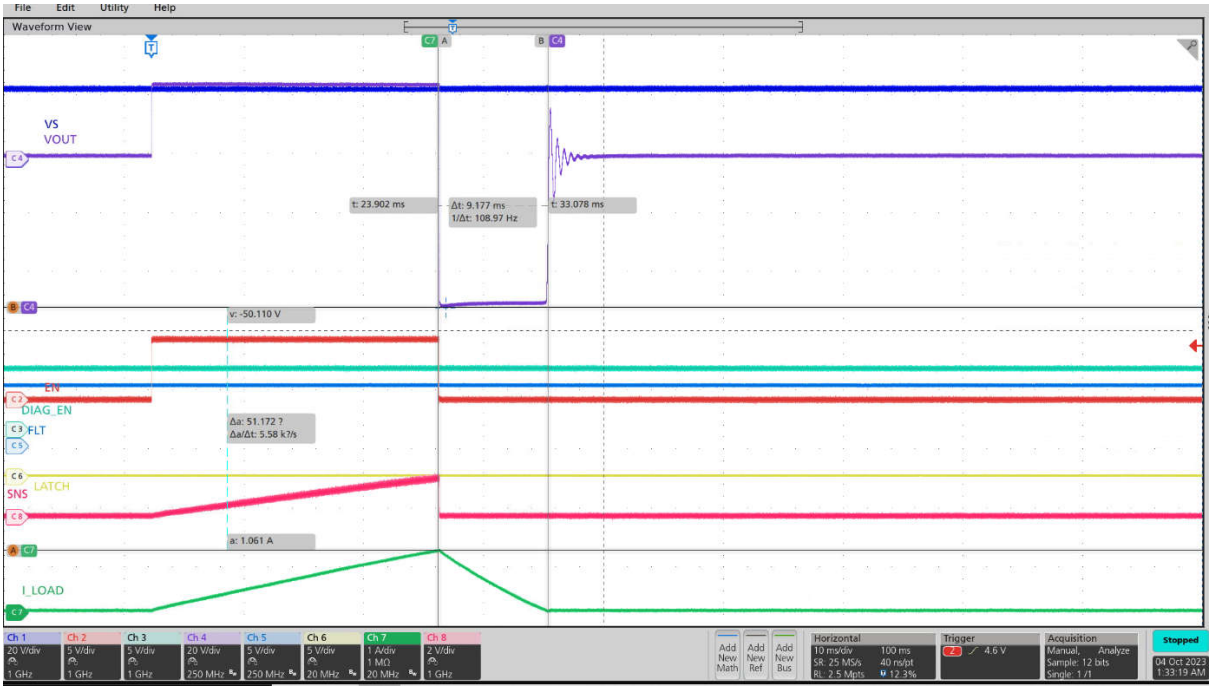



**図 8-13. TPS281C100 誘導性放電 (400mH)**

最大許容負荷インダクタンスは、デバイスで消費されるエネルギー、したがって負荷電流と誘導性負荷の関数です。図 8-14 に、デバイスが 125°C において 1 パルスの誘導性消費に耐えることができる最大エネルギーと負荷インダクタンスを示します。このデバイスは、2Hz の反復パルスを使用する 100 万個の誘導性反復パルスに対して、このエネルギーの 40% に耐えることができます。アプリケーションのパラメータがこのデバイスの制限を超えた場合は、フリーホイール ダイオードなどの保護デバイスを使用して、インダクタに蓄積されているエネルギーを消費します。

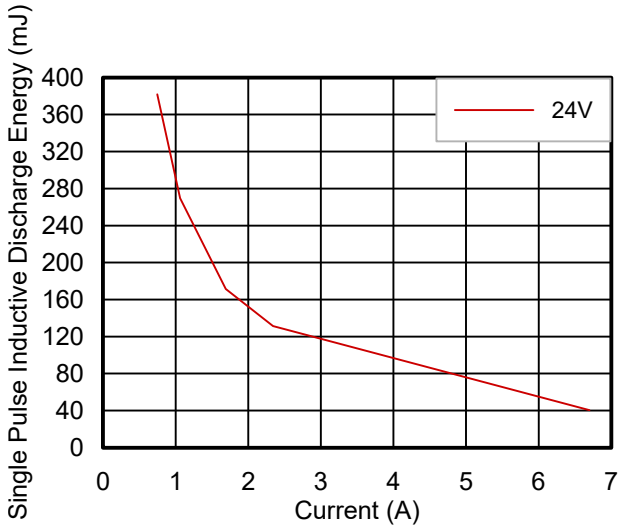



**図 8-14. TPS281C100 誘導性負荷放電エネルギー容量 (125°C、24V 電源時)**

### *8.5.5 完全な保護と診断*

DIAG_EN をイネーブルにすると、電流検出がアクティブになります。DIAG_EN が Low の場合、電流センスは無効になります。SNS 出力はハイ インピーダンス モードです。


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

**表 8-2. DIAG_EN ロジック表**

| DIAG_EN | EN 条件 | 保護および診断 |
|---|---|---|
| High | High | フォルト表を参照 |
| | Low | |
| Low | High | 診断は無効で、SNS 出力がハイ インピーダンスに設定されています。保護は通常であり、$\overline{\text{FAULT}}$ は TSD または ILIM を示し続けます。 |
| | Low | |

**表 8-3. ステータス表 (DIAG_EN = HIGH)**

| 条件 | EN | VOUT | OL_ON | FAULT | SNS | 動作 | 復帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常<br>標準センシング | L | L | L | ハイ インピーダンス | 0 | 通常 | |
| | H | H | L | ハイ インピーダンス | $I_{Load}$/ $K_{SNS}$ | 通常 | |
| 高精度センス<br>無効な範囲 | H | H | H | L | $I_{Load}$ / $K_{SNS}$ | $I_{Load}$>$I_{KSNS2_EN}$ であるため、FAULT がアサートされ、高精度センシングが有効でないことを通知します | 負荷が $I_{KSNS2_EN}$ を下回るか、OL_ON が LO にリセットされると、クリアされます。 |
| 高精度センス<br>通常動作 | H | H | H | ハイ インピーダンス | $I_{Load}$ / $K_{SNS2}$ | 高精度センシングのための $K_{SNS2}$ センス比を有効にします。有効な条件が $I_{Load}$<$I_{Ksns2_EN}$ で満たされているため、FAULT はハイ インピーダンスのままになります。 | |
| 過電流 | H | $V_S$ - $I_{LIM}$*$R_{LOAD}$ | x | L | $V_{SNSFH}$ | サーマル シャットダウンまで、電流制限値に電流を保持します | |
| STG、相対サーマル シャットダウン、絶対サーマル シャットダウン | H | H/L | x | L | $V_{SNSFH}$ | デバイスが相対的または絶対的なサーマル シャットダウンに達するとシャットダウン | $T_{HYS}$ が満たされており、$t_{RETRY}$ 時間より長い場合は自動再試行 |
| 開放負荷 | H | H | L | ハイ インピーダンス | $I_{Load}$ / $K_{SNS}$ ≅ 0 | 通常の動作では、ユーザーはそれが開放負荷かどうかを判断できます | |
| | H | H | H | ハイ インピーダンス | $I_{Load}$ / $K_{SNS2}$ ≅ 0 | 通常の動作では、ユーザーはそれが開放負荷かどうかを判断できます | |
| | L | H | L | L | $V_{SNSFH}$ | 内部プルアップ抵抗はアクティブです。$V_S$ - $V_{OUT}$ < $V_{OL}$ の場合、フォルトはアクティブになります | フォルトが解消するとクリアされます |
| 極性反転 | x | x | x | x | x | チャネルをオンにして消費電力を抑えます。外部グラウンド ネットワークによってグラウンド ピンへの電流を制限します | |

#### 8.5.5.1 オープン負荷の検出

**オン状態の開放負荷検出**

メイン チャネルが有効になっているとき、SNS または $\overline{FLT}$ ピンの電圧を読み取ることでフォルトを診断し、ユーザーが判断します。高精度電流センスの利点は、このデバイスが非常に低い開放負荷検出スレッショルドを達成できることです。このスレッショルドにより、通常動作領域が拡大します。「高精度センス モード」セクションに説明されているように、このモードを使用すれば、低電流を正確に検出できます。

**オフ状態の開放負荷検出**

チャネルがオフ状態で、負荷が接続されている場合、出力電圧は 0V にプルされます。開放負荷の場合、出力電圧は電源電圧に近く、$V_S$ - $V_{OUT}$ < $V_{ol,off}$ となります。FLT ピンは Low になってマイコンにフォルトを通知し、SNS ピンは $I_{SNSFH}$ にプルアップされます。出力には常に漏れ電流 $I_{ol,off}$ が流れています。これは、内部のロジック制御経路や外部の湿気や腐食などが原因で発生します。そのため、TI ではリーク電流をオフセットするための内部プルアップ抵抗を実装しました。通常動作モードでの誤検出を避けるため、このプルアップ電流は出力負荷電流よりも小さくする必要があります。スタンバ


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

イ電流を低減するために、テキサス インスツルメンツは DIAG_EN ピンで制御されるプルアップ抵抗と直列にスイッチを実装しました。プルアップ抵抗の値は $R_{OL_OFF}$ です。

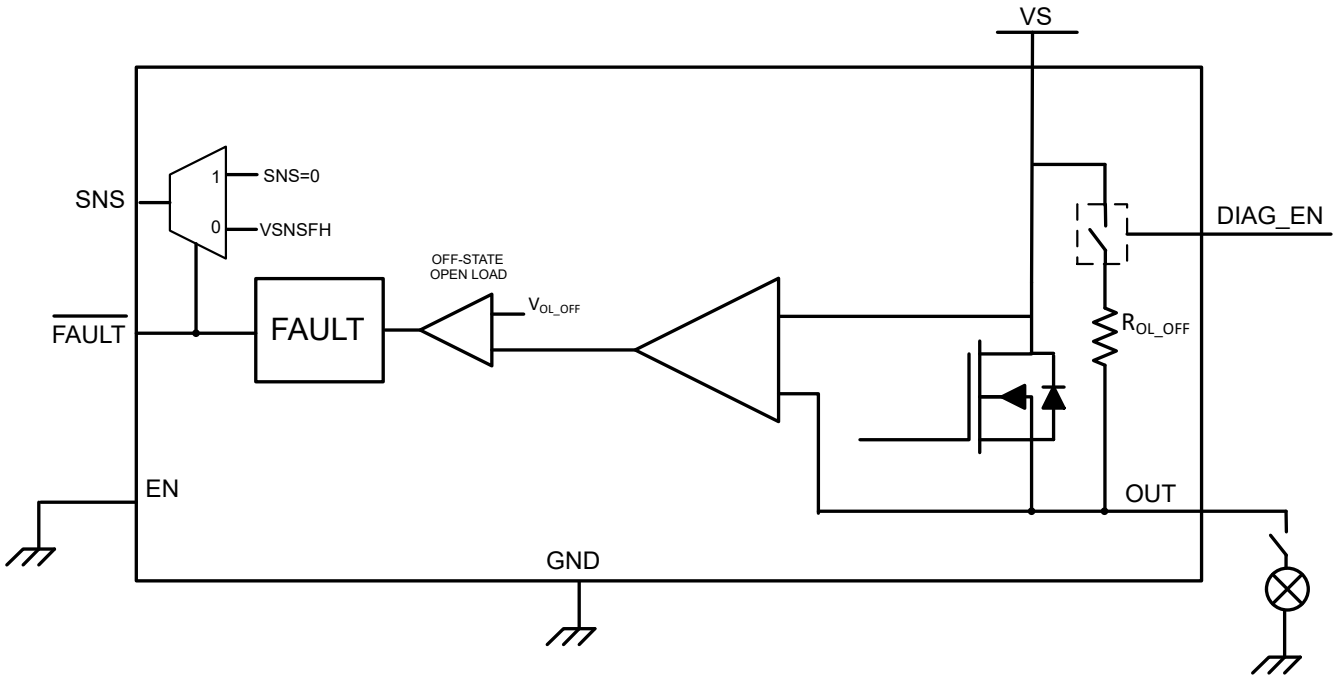



**図 8-15. オフ状態の開放負荷検出回路**

#### 8.5.5.2 過熱保護動作

過熱保護動作は、起こり得るイベントを 2 つのカテゴリに分割することができます。図 8-16 に、これらの各カテゴリを示します。

1. **相対サーマル シャットダウン**: デバイスは、過電流イベントでも有効です。DIAG_EN ピンが high であれば、SNS および FLT で診断を監視できます。SNS が $V_{SNSFH}$ のときは、出力電流は $I_{ILIM}$ レベルまで上昇し、FLT は Low になります。このように大量の電流が流れるため、FET の接合部温度はコントローラの温度に対して急速に上昇します。パワー FET 温度がコントローラの接合部温度 $\Delta T = T_{FET} - T_{CON} > T_{REL}$ を上回ると $T_{REL}$ に上昇すると、デバイスはシャットダウンします。FLT および部品が $t_{RETRY}$ タイマが満了するのを待機するまで、フォルトは SNS に継続的に表示されます。$t_{RETRY}$ タイマが期限切れになると、EN がまだ High であるため、デバイスは再び $I_{ILIM}$ 状態に戻ります。
2. **絶対サーマル シャットダウン**: この場合、周囲温度は前のケースよりもはるかに高くなります。DIAG_EN が High の場合、過電流イベント発生時でもデバイスは有効な状態のままです。ただし、この場合、接合部温度は上昇し、絶対基準温度 TABS に達すると、シャットダウンされます。$T_J < T_{ABS} - T_{hys}$ でありかつ $t_{RETRY}$ タイマが共に終了するまで、デバイスは回復しません。

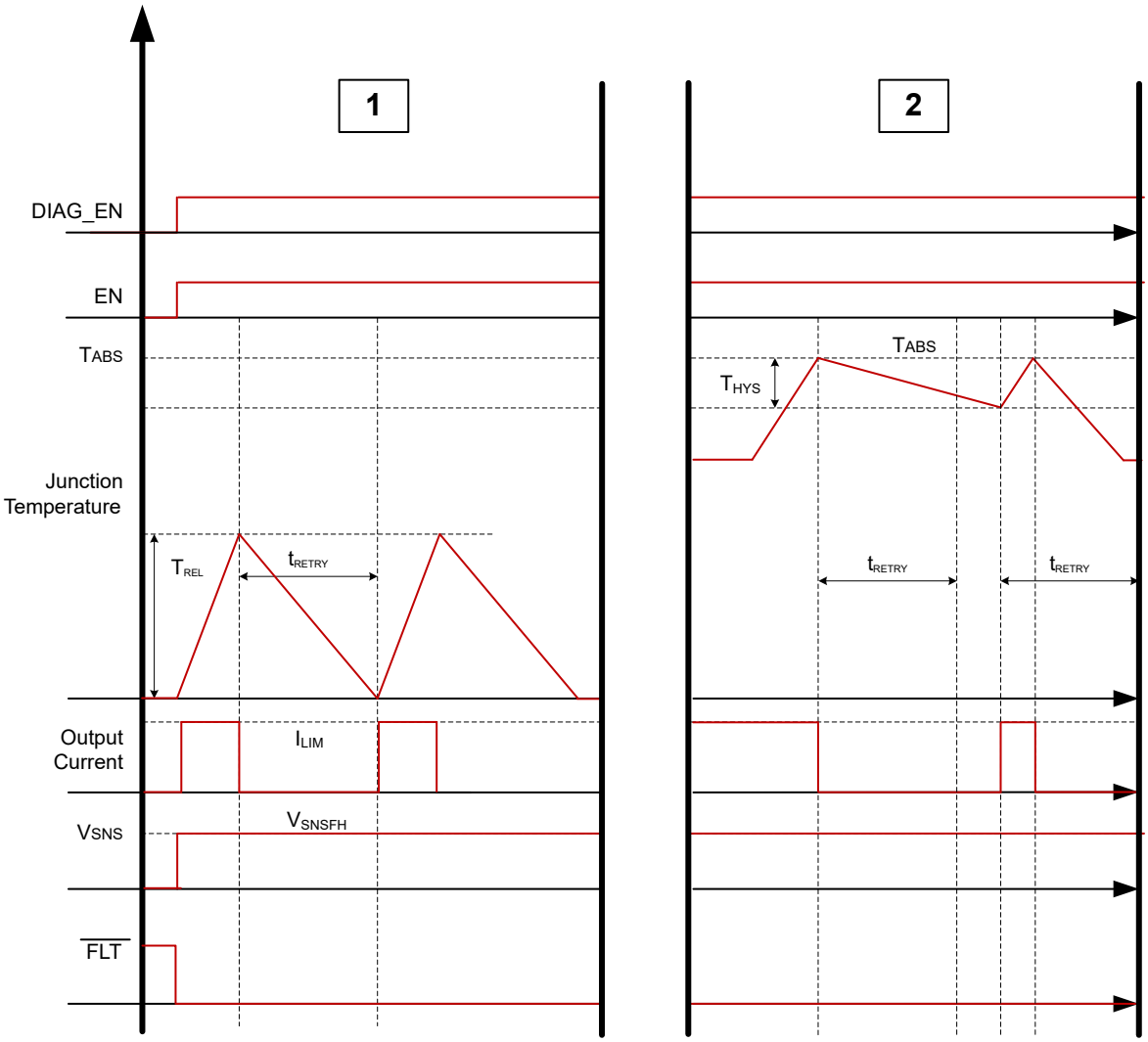



**図 8-16. 熱挙動**

#### 8.5.5.3 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護

デバイスは電源電圧 $V_S$ を監視することで、電源電圧が低すぎるときに予期しない動作が発生することを防ぎます。電源電圧が $V_{UVLOF}$ まで低下すると、出力段が自動的にシャットダウンされます。電源電圧が $V_{UVLOR}$ まで上昇すると、デバイスはオンになります。過電流イベントが UVLO スレッショルドをトリップすると、デバイスはシャットオフし、その後再起動して電流制限状態に安全に戻ります。

#### 8.5.5.4 逆極性保護

##### *8.5.5.4.1 方法 1*

ブロッキング ダイオードは VBB に接続されています。逆極性時にデバイスと負荷の両方が保護されます。ブロッキングダイオードは、バッテリの逆接続条件では電流を流しません。


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

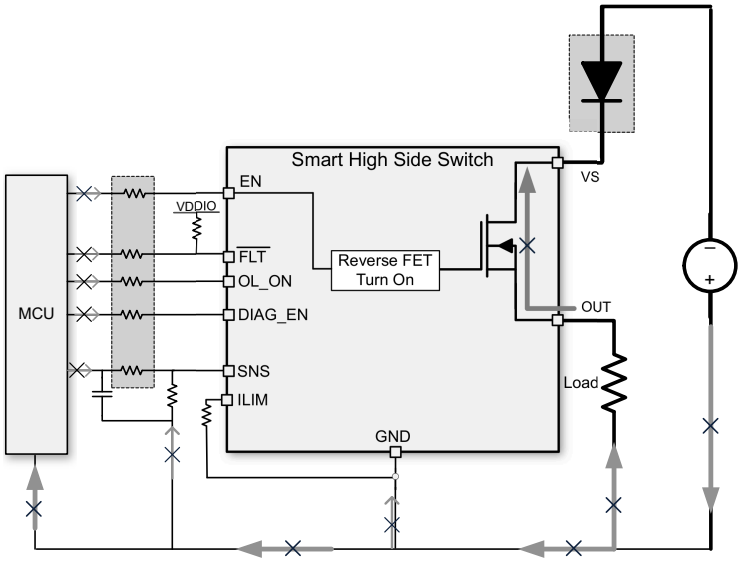



**図 8-17. ブロッキング ダイオードによる逆電流保護**

#### *8.5.5.4.2 方法 2 (GND ネットワーク保護)*

この接続では、ハイサイド デバイスだけが保護されます。負荷逆ループは負荷によって制限されます。逆極性が発生した場合、パワー FET を流れる連続逆電流が $I_{rev}$ より小さい必要があることに注意してください。3 種類のグランド ピン ネットワークのうち、TI ではタイプ 3（抵抗とダイオードを並列に接続）を強く推奨します。デバイスの GND と基板の GND との間に使用する接続の種類に関わらず、GND 電圧のシフトが発生する場合は、通常動作を維持するために以下のような適切な接続を確立してください。

- NC ピンはフローティングにするか、デバイスの GND に接続します。TI はフローティングのままにすることを推奨します。
- デバイスの GND に電流制限プログラマブル抵抗を接続します。

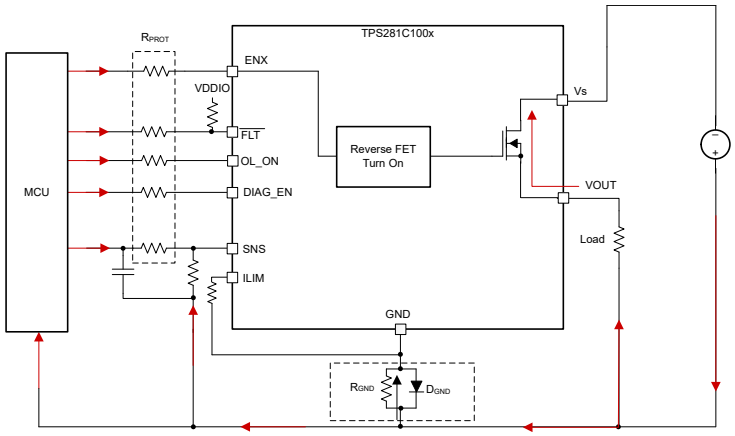



**図 8-18. GND ネットワークによるリバースプロテクション**

- **タイプ 1 (抵抗):** バッテリの逆接続時または負の ISO パルス印加時には、抵抗値が大きいほど電流制限効果が上がります。ただし、通常動作モードでは GND シフトも大きくなります。また、抵抗の消費電力も考慮してください。

$$R_{GND} \leq \frac{V_{GNDshift}}{I_{nom}} \quad (9)$$

$$R_{GND} \geq \frac{(-V_{CC})}{(-I_{GND})} \quad (10)$$

ここで、

- $V_{GNDshift}$ は GND シフトの最大値で、HSS とマイコンによって決定されます。TI は、≤ 0.6V の値を推奨します。
- $I_{nom}$ は公称動作電流です。
- $-V_{CC}$ はバッテリ ライン上で観測される最大逆電圧です。
- $-I_{GND}$ は、グランド ピンが耐えることのできる最大逆電流であり、セクション 6.1 で利用可能です。

複数のハイサイド パワー スイッチを使用する場合は、デバイス間で抵抗を共有できます。

- **タイプ 2 (ダイオード):** 逆電圧をブロックするためにダイオードが必要ですが、これはグランド シフト (≈ 600mV) にもつながります。ただし、電源オフ時の異常状態を回避するため、誘導性負荷は許容されません。
- **タイプ 3 (抵抗とダイオードの並列接続 [推奨]):** 誘導性負荷がスイッチオフになると、負のピーク スパイクが発生する場合があり、HSD またはダイオードの破損につながるおそれがあります。そのため、TI では、誘導性負荷の駆動時には抵抗とダイオードを並列に使用することを推奨しています。4.7kΩ 抵抗と $I_F$ > 100mA のダイオードを選んで並列に使用することを推奨します。複数のハイサイド スイッチを使用する場合は、デバイス間で抵抗とダイオードを共有できます。

#### 8.5.5.5 マイコン I/O の保護

負のサージ パルスや、誘導性負荷によるバッテリ損失など、多くの条件下では、デバイスの GND ピンに負の電位が生じて、マイコンの I/O ピン (一般的に、ピンに接続された内部回路) が損傷する可能性があります。そのため、マイコンと HSS の間に直列抵抗が必要です。

また、GND の損失に対する適切な保護のため、TI は RPROT 抵抗に 10kΩ 抵抗を推奨しています。

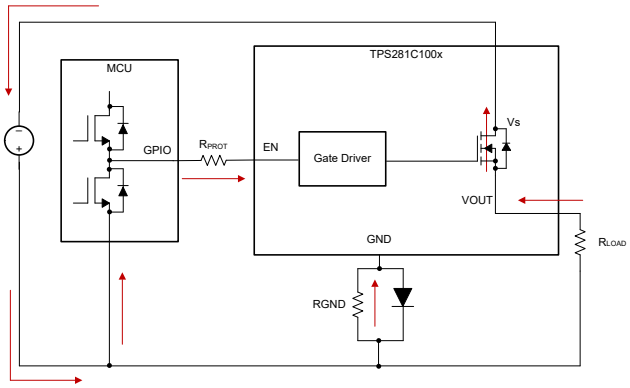



**図 8-19. マイコン IO 保護**

#### 8.5.5.6 診断イネーブル機能

診断イネーブル ピン DIAG_EN により、複数のデバイス間で同じセンス抵抗と ADC ラインまたは I/O ポートを共有することで、電流センスまたはデジタル ステータス用にマイコンの診断入力を多重化できます。

さらに、このピンはデバイスの消費電力の管理に使用できます。出力オン期間中に連続的な検出出力診断が必要ない場合、診断無効化機能により動作電流が低減されます。一方、出力オフ期間や診断無効化機能は、スタンバイ状態における消費電流を低減します。


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

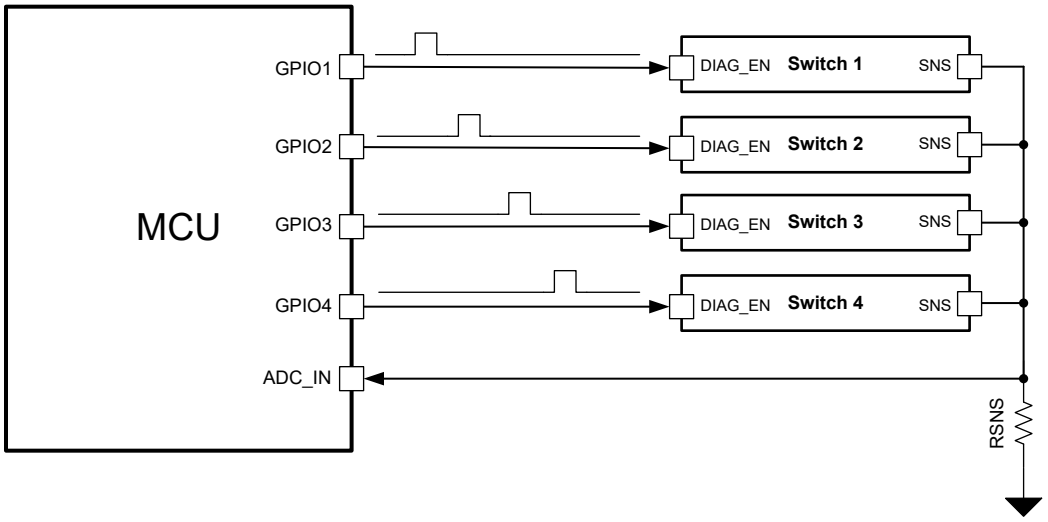



**図 8-20. 抵抗の共有**

#### 8.5.5.7 GND 喪失

グランド接続がデバイス レベルまたはモジュール レベルで失われる場合があります。グランド接続が失われ、電源電圧が 48V 未満の場合、EN 入力レベルに関係なく、チャネル出力は無効化されます。グランド接続が失われた時点でスイッチがすでに無効になっている場合、チャネルが有効になっても出力は無効のままになります。出力から負荷への定常電流 (システム グランドに接続された状態) は、このドキュメントの「仕様」セクションで規定されているレベルを下回っています。グランドが再接続されると、通常動作が再開されます。

# 9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

## 9.1 使用上の注意

## 9.2 代表的なアプリケーション

図 9-1 に、外部回路パラメータの設計方法の例を示します。

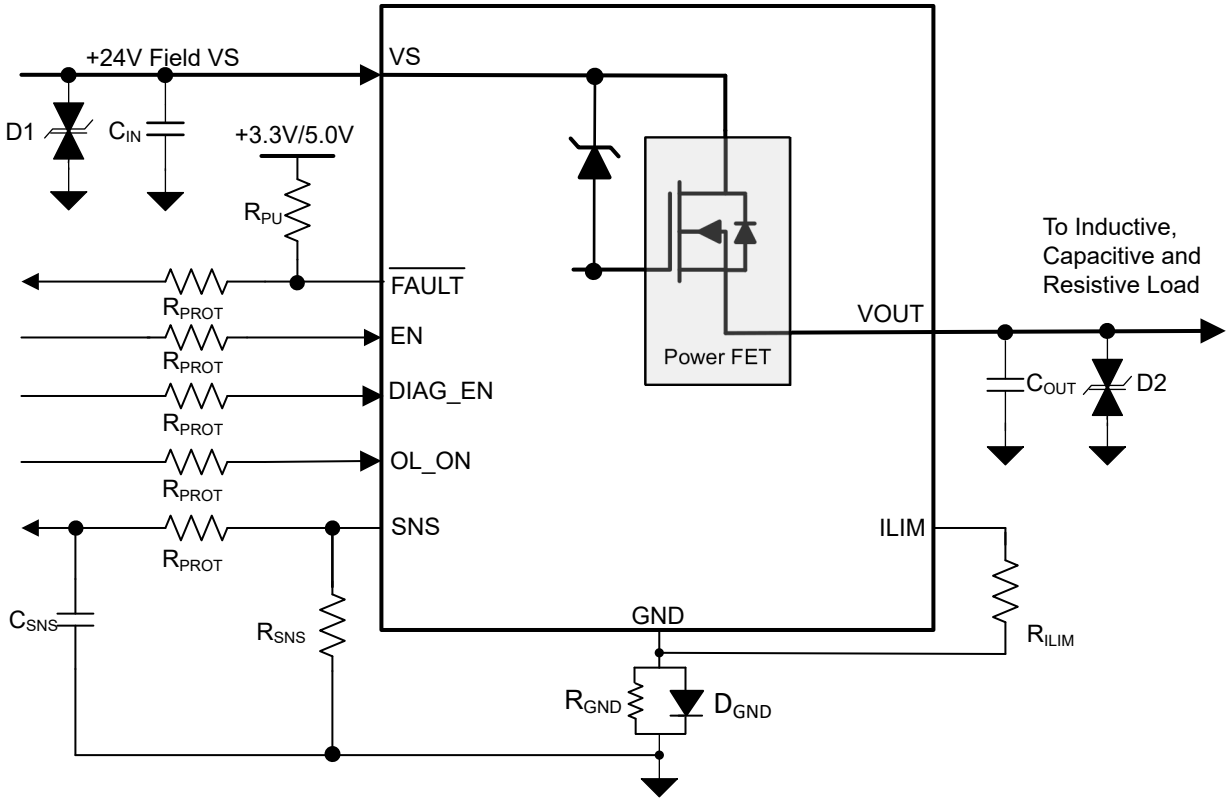



**図 9-1. 代表的なアプリケーション回路**

### *9.2.1 設計要件*

| 部品 | 標準値 | 目的 |
|---|---|---|
| D1 | SMBJ36A | 電源入力でサージ電圧をクランプします。サージ保護が必要な場合は必須となります。セクション 9.2.1.2 を参照ください。 |
| D2 | SMBJ33CA | 電源出力でサージ電圧をクランプします。サージ保護が必要な場合は必須となります。セクション 9.2.1.2 を参照ください。 |
| CIN1 | 100nF | 入力電源を安定させ、低周波ノイズを除去します。 |
| CIN2 | 4.7nF | 過渡電圧のフィルタリング (ESD、IEC 61000-4-5 など) と電磁ノイズの改善。 |
| RPROT | 10kΩ | マイコンとデバイスの I/O ピンの保護抵抗 — 逆極性保護のためのオプション |
| RILIM | 10kΩ ～ 50kΩ | 調整可能な電流制限スレッショルド |


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

| 部品 | 標準値 | 目的 |
|---|---|---|
| RSNS | 1kΩ | センス電流をセンス電圧に変換します。 |
| CSNS | 1nF | SNS ラインの RPROT と組み合わせることでローパス フィルタを作成し、マイコンの ADC に入るノイズをフィルタ処理します。 |
| CVOUT | 22nF | EMI 特性の改善、電圧過渡のフィルタリング |
| RGND | 4.7kΩ | 誘導性負荷のターンオフ時に GND 電位を安定させます。逆極性保護のためのオプションです |
| DGND | BAS21 ダイオード | 通常動作中は GND をシステム グランドに近づけて維持します。逆極性保護のためのオプションもあります |

#### 9.2.1.1 IEC 61000-4-4 EFT

TPS281C100 は、最小 22nF の出力キャパシタンスで、IEC 61000-4-4 に準拠した電気的高速過渡 (EFT) に耐えられるように設計されています。デバイスは、VS および VOUT ポートで ±2kV EFT に合格しています。EN が Low の場合、デバイスは EFT パルス中はオフ状態を維持し、パルス終了後は正常に動作します。EN が High の場合、デバイスはパルスに耐え、その後正常に機能します。

オフ状態でのアクティブ EFT 検出のため、TPS281C100 はオフ状態のとき検出回路がアクティブになります。これは、他のハイサイド スイッチの通常のシャットダウン電流と比較して、より高いオフ状態電流 $I_{IDLE, VS}$ または $I_{IDLE, VS_DIAG}$ を供給します。

また、DIAG_EN が Low のとき、デバイスは、出力側の最大 $I_{OUT (OFF, SINK)}$ までシンクできる電流シンクを有効にします。これは、EFT 中にデバイスからのリーク電流をオフセットし、オフ状態および EFT イベント時に出力電圧を 0V 近くに維持するのに役立ちます。DIAG_EN が High のとき、出力電圧を VS 付近でプルアップするオフ状態のプルアップ抵抗があります。この場合、出力電流シンクはアクティブになりません。

#### 9.2.1.2 IEC 61000-4-5 サージ

TPS281C100 の IEC61000-4-5 サージに合格するには、サージ エネルギーを吸収するために入力と出力の両方の TVS ダイオードが必要です。入力および出力 TVS ダイオードの選択には、以下のような特定の要件があります。

出力 TVS の要件:

出力 TVS には、出力サージのためにサージ エネルギーを吸収することと、誘導性ターンオフ時に誘導エネルギーを消磁するのに役立つという 2 つの目的があります。出力サージ発生時に内部 VDS クランプが作動する前に出力 TVS が確実にクランプされるようにするには、TVS のクランプ電圧を $VS + V_{TVS, CLMAP} < V_{DS, Clamp, min}$ となるように選択する必要があります。標準の 24V 入力システムの場合、出力に **SMBJ33CA** の使用を推奨します。

入力 TVS の要件:

入力 TVS は、通常の動作に干渉しないように選択する必要があります。入力 TVS の逆スタンドオフ電圧は、通常の動作入力電圧よりも高い必要があります。もう 1 つの要件は、入力 TVS は出力 TVS と等しいかそれ以上の電圧定格である必要があり、出力サージが発生した場合に入力 TVS ではなく出力 TVS によってサージ エネルギーが確実にクランプされるようにすることです。標準の 24V 入力システムの場合は、入力には **SMBJ36A** を推奨します。入力側には単方向 TVS が必要となることに注意してください。これは、負の入力サージに対してデバイスの絶対最小電圧が侵害されないようにするためです。

### *9.2.2 詳細な設計手順*

#### 9.2.2.1 RILIM の選択

TPS281C100 の電流制限設定レベルは、余裕をもって最大 DC 電流を許容しつつ、電流制限を最小限に抑えることで、フォルト時のスイッチ内のエネルギー消費と入力電源への負荷を最小限に抑える必要があります。

ワーストケース (最小) の電流制限が最大公称負荷電流よりも高くなるように、公称電流制限を設定します。アプリケーションが 500mA デジタル出力モジュールの場合で、最大電流が 1A の場合は、電流制限を設定する方法は 2 つあります。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

1 つ目は、電気的特性表に記載されている抵抗値を使用する方法です。25kΩ $R_{ILIM}$ 抵抗の設定により、電流制限の最小レベルは 1.5A に設定されます。これは、最大公称負荷電流を上回る値です。設定値の上限である 2.3A がアプリケーションで許容範囲内であれば、25kΩ $R_{ILIM}$ 抵抗を使用します。

アプリケーションでモジュールに認識される最大電流をできるだけ最小化する必要がある場合は、最小電流制限レベルが最大負荷電流にできるだけ近い値になるように電流制限抵抗を選択します。最小電流制限を 1A にするには、標準的な電流制限を同じ比率で 1 × 1.32 = 1.32A にスケーリングします。線形補間により、1.32A (標準値) での $K_{CL}$ 値は 48.5A × kΩ です。

$$R_{ILIM} = K_{CL} / I_{CL} \quad (11)$$

$R_{ILIM}$ の計算値は 36.7kΩ であり、最も近い 1% 標準抵抗値は 36.5kΩ です。

#### 9.2.2.2 RSNS の選択

表 9-1 に、このアプリケーションにおける負荷電流センスの要件を示します。$K_{SNS}$ 値はデバイスに対して規定されており、セクション 6 に記載されています。

**表 9-1. $R_{SNS}$ 計算パラメータ**

| パラメータ | 数値の例 |
|---|---|
| 電流センス比 ($K_{SNS1}$) | 800 |
| 電流センス比 ($K_{SNS2}$) | 24 |
| 診断可能な最大負荷電流 | 3A |
| 診断可能な最小負荷電流 | 4mA |
| フルスケール ADC 電圧 | 5.0V |
| ADC の分解能 | 10 ビット |

最大 3A の負荷電流測定により、過負荷が発生した場合でも、設定された電流制限値以下であれば、マイコンがそれを検出して FET をオフにすることで対応できることが確認されます。また、4mA という低レベルにより、低負荷電流を正確に測定し、開放負荷フォルトとサポートされている公称負荷電流を区別することが可能になります。負荷電流が 50mA 未満の場合、高精度センシングを可能にし、センス比を KSNS1 から KSNS2 に変更することができます。これにより、より分解能の高い ADC が不要になり、検出精度も向上します。詳細については、セクション 8.5.1 を参照してください。

$R_{SNS}$ 抵抗値は、診断可能な最大負荷電流において SNS ピン電圧 ($V_{SNS}$) が ADC のフルスケールの約 90% になるように選択する必要があります。この設計では、フルスケール (FS) の 80% を超える ADC 値はすべてフォルトと見なされます。また、$R_{SNS}$ 抵抗値は、診断可能な最小負荷電流によって $V_{SNS}$ が ADC の少なくとも数 LSB を下回らないことを確認する必要があります。

例で与えられた値では、1.0kΩ のセンス抵抗は、両方の要件を満たします。

**表 9-2. $V_{SNS}$ の計算**

| センス モード | OL_ON | 負荷 (A) | センス比 | $I_{SNS}$ (mA) | $R_{SNS}$ (Ω) | $V_{SNS}$ (V) | 5V ADC の % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準センシング | LO | 3A | 800 | 3.75 | 1000 | 3.75 | 75% |
| 高精度センシング | HI | 0.004A | 24 | 0.166 | 1000 | 0.166 | 3.3% (≅34LSBs) |

## 9.3 電源に関する推奨事項

TPS281C100 デバイスは、24V の産業用システムで動作するように設計されています。許容される電源電圧範囲 (VS ピン) は、デバイスの GND ピンを基準として VS ピンで測定した値で、6V ～ 60V です。この範囲において、デバイスは セクション 6.5 に記載されているすべてのパラメータ仕様を満たしています。デバイスは、SELV 電源フォルトなど、この範囲を超える電圧過渡現象にも耐えられるように設計されています。


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

入力電源を安定させ、低周波ノイズをフィルタリングして除去するため、Vs 電源入力に 0.1uF コンデンサを配置することを推奨します。電源は、過渡負荷電流のすべてのステップに耐えられる必要があります。電源が大きな過渡電流または大きな負荷電流ステップに反応しない場合、入力にバルクコンデンサが必要となることがあります。

## 9.4 レイアウト

### *9.4.1 レイアウトのガイドライン*

サーマル シャットダウンを防止するため、$T_J$ は 125℃ 未満にする必要があります。出力電流が非常に高い場合は、消費電力が大きくなる可能性があります。HTSSOP および WSON パッケージは、優れた熱インピーダンス特性を備えています。ただし、PCB レイアウトは非常に重要です。適切な PCB 設計は、熱伝導を最適化することができ、これはデバイスの長期的な信頼性にとって絶対的に不可欠です。

- PCB 上の銅領域の面積を大きくすれば、基板の熱伝導率も大きくなります。パッケージから周囲への主要な熱伝導経路は、PCB 上の銅領域です。設計で、パッケージの反対側の PCB にヒートシンクが設けられていない場合は、銅領域を最大限大きくすることがきわめて重要です。
- 基板の熱伝導率を最適化するため、パッケージのグランド パッドの直下に、できるだけ多くのサーマル ビアを追加します。
- すべてのサーマル ビアは、はんだボイドの発生を防ぐため、基板の両側で、めっきして閉じるか、栓で塞いで覆っておく必要があります。信頼性および性能を確保するために、半田の被覆率は 85% 以上でなければなりません。

#### 9.4.1.1 EMC に関する考慮事項

### *9.4.2 レイアウト例*

#### 9.4.2.1 GND ネットワークを使わない DNT レイアウト

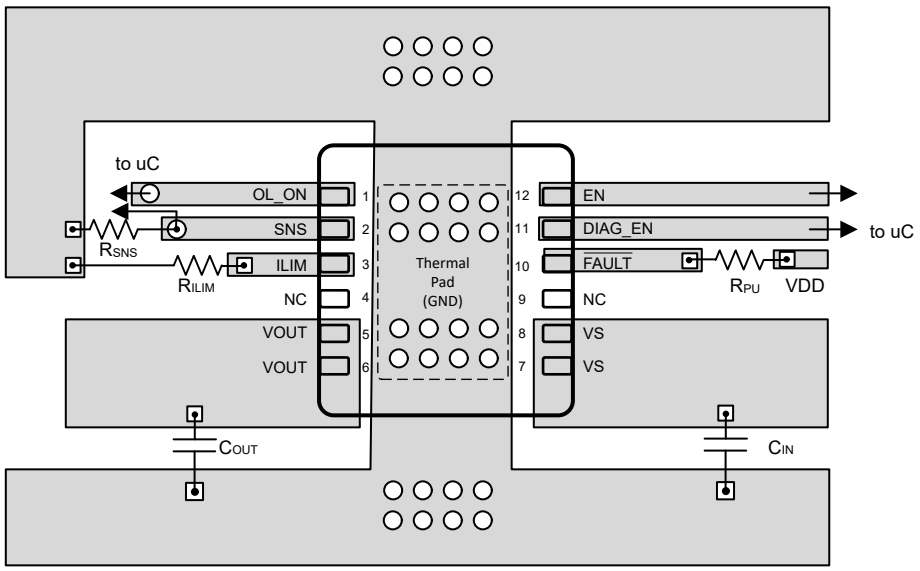



**図 9-2. GND ネットワークを使わない DNT レイアウト**

### *9.4.3 熱に関する検討事項*

デバイスには、過熱状態からの保護のため、サーマル シャットダウン (TABS) 回路が組み込まれています。連続の通常動作では、接合部温度がサーマル シャットダウン トリップ ポイントを超えないようにする必要があります。接合部温度が サーマル シャットダウン トリップ ポイントを超えると、出力はオフになります。接合部温度が低下し、サーマル シャットダウン トリップ ポイントを下回ると、出力が再度オンになります。

式 12 に従って、デバイスが消費する電力を計算します。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

$$P_T = I_{OUT}^2 \times R_{DSON} + V_S \times I_{Q,VS} \quad (12)$$

ここで、

- $P_T$ = デバイスの合計消費電力

デバイスによって消費される電力を求めてから、周囲温度とデバイスの熱インピーダンスから接合部温度を計算します。

$$T_J = T_A + R_{\theta JA} \times P_T \quad (13)$$

詳細については、『抵抗性、誘導性、容量性、照明の負荷を駆動する方法』アプリケーション ノートを参照してください。


Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

# 10 デバイスおよびドキュメントのサポート

## 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

## 10.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

## 10.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 10.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

## 10.5 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

# 11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

| Changes from Revision A (September 2024) to Revision B (October 2026) | Page |
|---|---|
| • ドキュメント全体を通して PWP パッケージ オプションを削除 | 1 |
| • 式 12 を $I_{NOM}$ から $I_{Q,VS}$ に変更 | 39 |

| Changes from Revision * (December 2024) to Revision A (September 2024) | Page |
|---|---|
| • B バージョンの「電気的特性」セクションを更新 | 5 |

# 12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number | Status (1) | Material type (2) | Package \| Pins | Package qty \| Carrier | RoHS (3) | Lead finish/ Ball material (4) | MSL rating/ Peak reflow (5) | Op temp (°C) | Part marking (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS281C100ADNTR | Active | Production | WSON (DNT) \| 12 | 5000 \| LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 to 125 | 281C0 |
| TPS281C100ADNTR.A | Active | Production | WSON (DNT) \| 12 | 5000 \| LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 to 125 | 281C0 |
| TPS281C100BDNTR | Active | Production | WSON (DNT) \| 12 | 5000 \| LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 to 125 | B81C0 |

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

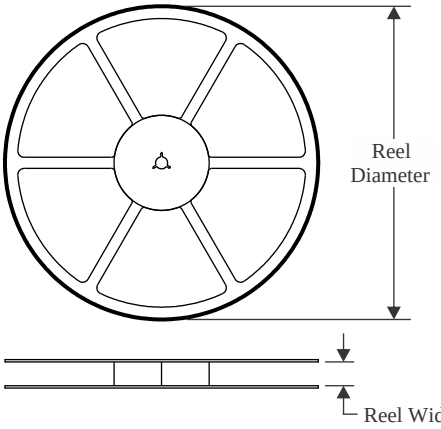
Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

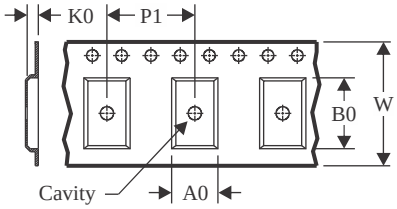
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## TAPE AND REEL INFORMATION

**REEL DIMENSIONS**

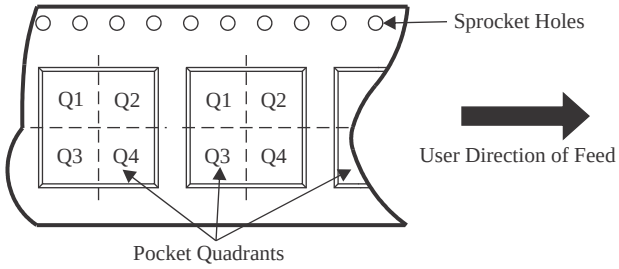



**TAPE DIMENSIONS**




| | |
|---|---|
| A0 | Dimension designed to accommodate the component width |
| B0 | Dimension designed to accommodate the component length |
| K0 | Dimension designed to accommodate the component thickness |
| W | Overall width of the carrier tape |
| P1 | Pitch between successive cavity centers |

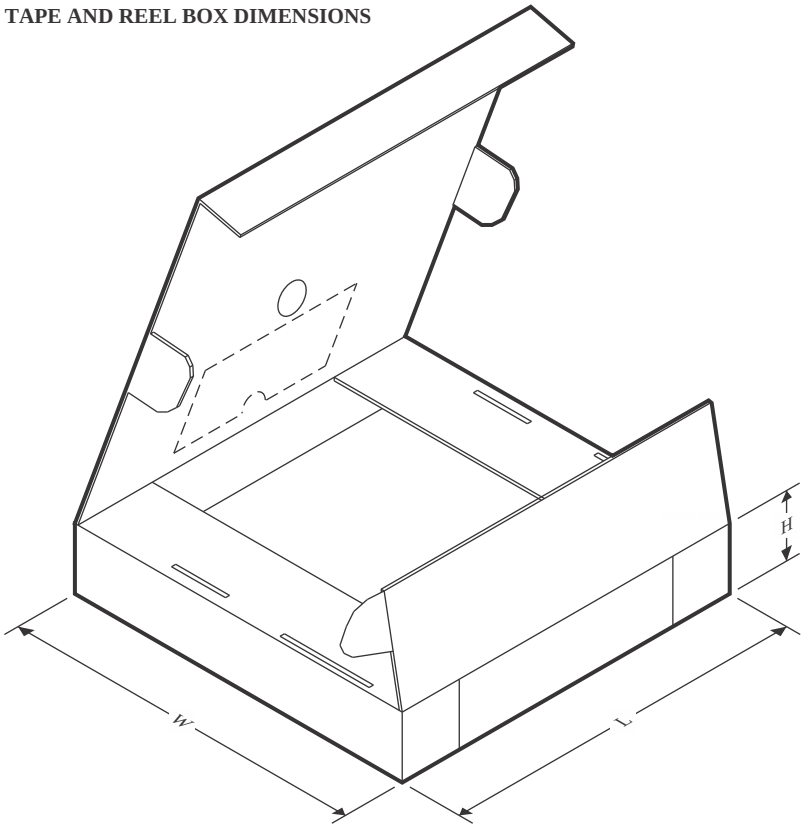
**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**




*All dimensions are nominal

| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS281C100ADNTR | WSON | DNT | 12 | 5000 | 330.0 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 1.15 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
| TPS281C100BDNTR | WSON | DNT | 12 | 5000 | 330.0 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 1.15 | 8.0 | 12.0 | Q2 |

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS




*All dimensions are nominal

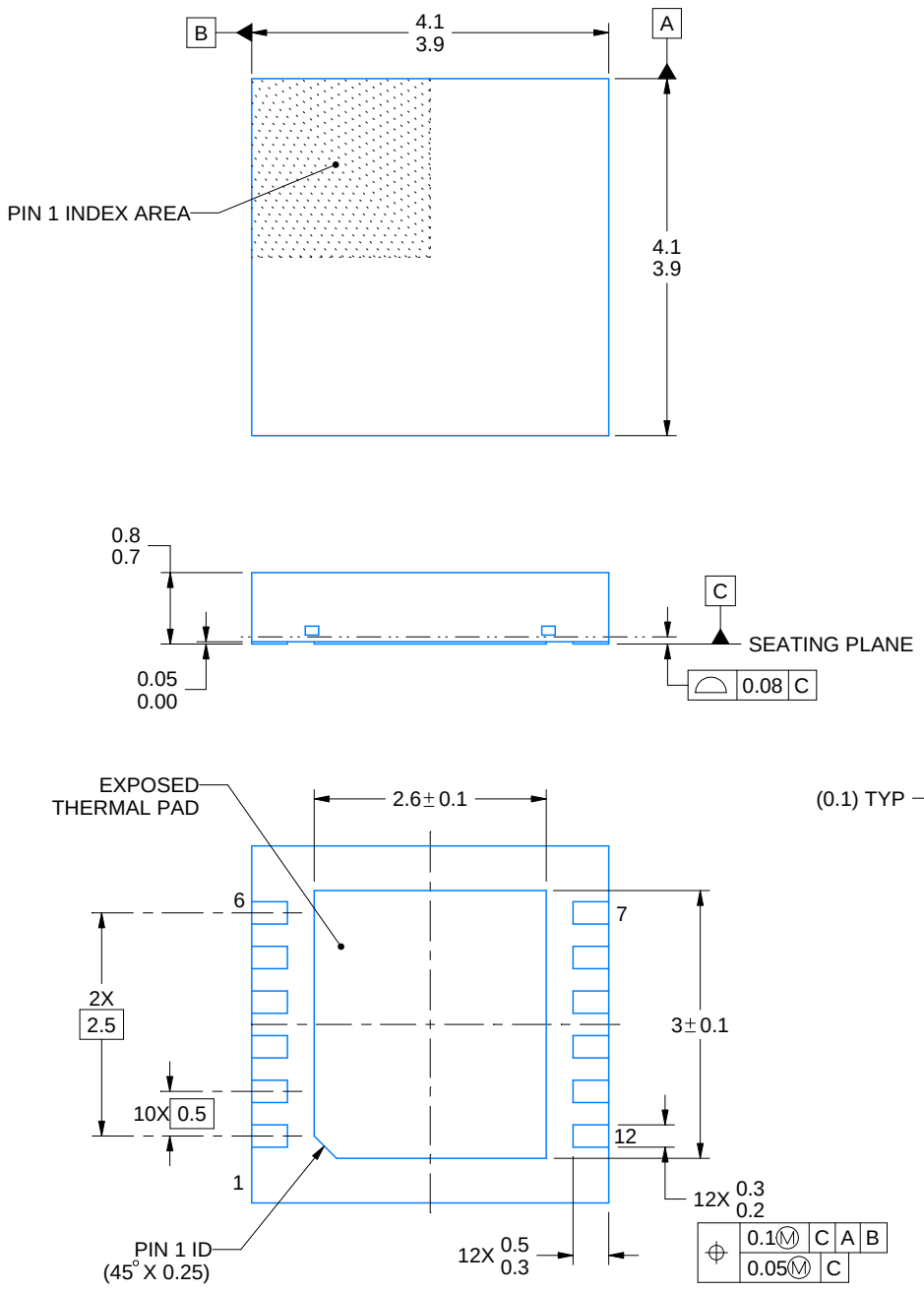
| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS281C100ADNTR | WSON | DNT | 12 | 5000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
| TPS281C100BDNTR | WSON | DNT | 12 | 5000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |

# DNT0012B

# PACKAGE OUTLINE

## WSON - 0.8 mm max height

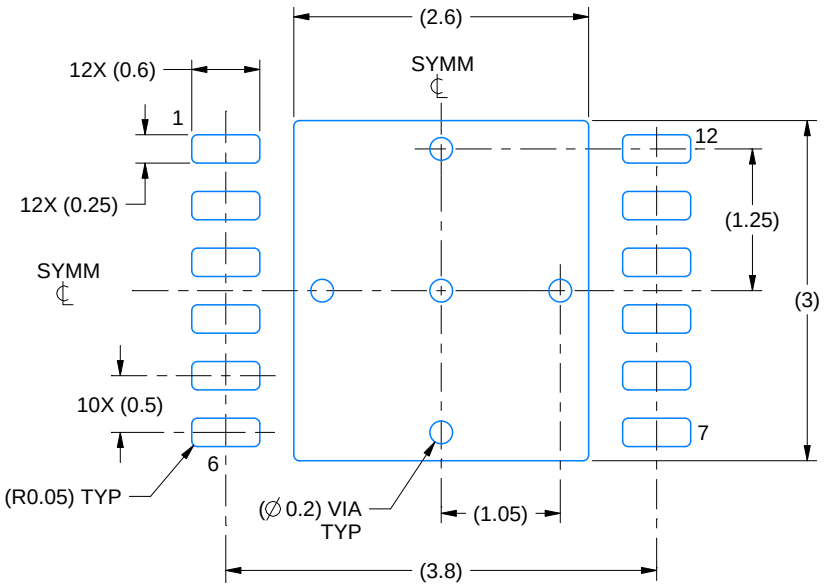
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



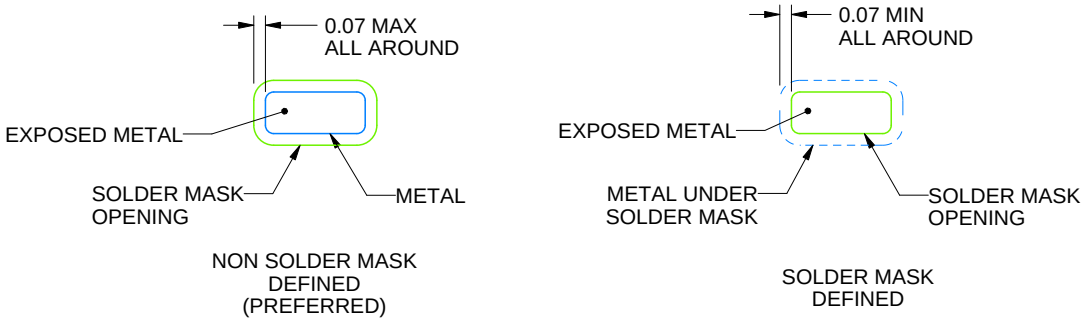

4214928/C 10/2021

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.




LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

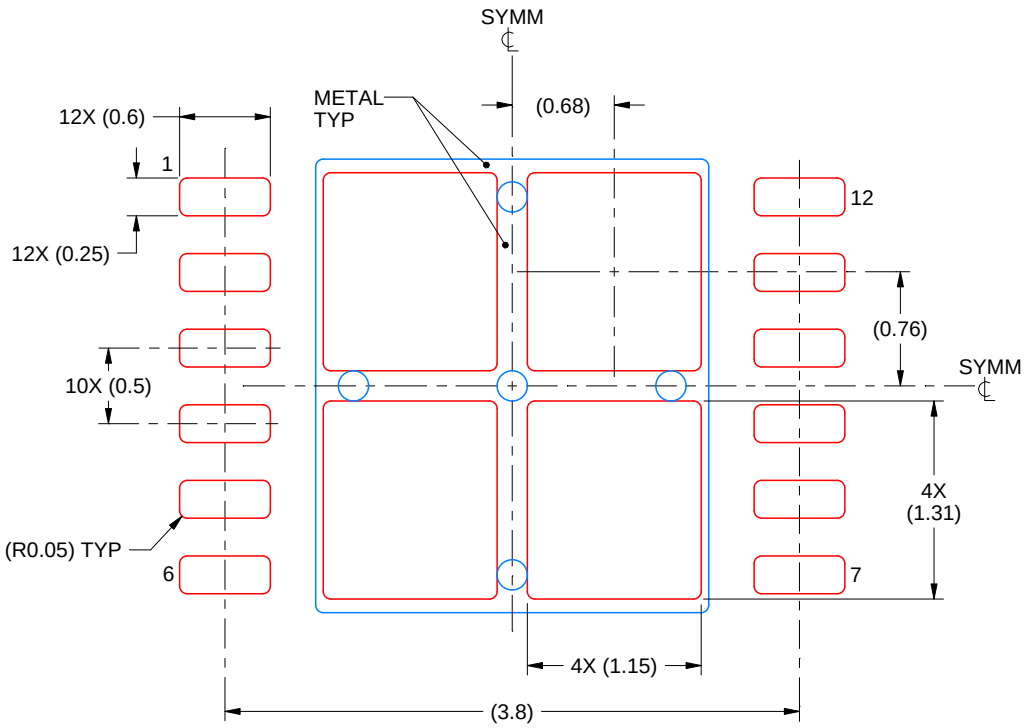



SOLDER MASK DETAILS

4214928/C 10/2021

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).




SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
77% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:20X

4214928/C 10/2021

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

# 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月